

2025年3月期(2024年4月～2025年3月) 決算説明資料

2025年5月13日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとは認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2025年3月期連結決算概要

2025年3月期連結決算概要

- 生成AIの普及を背景に先端DRAM向け設備投資が活発。Logic/Foundry向け設備投資は成熟ノード向けに落ち着きが見られるものの、先端ノード向けが増加。NAND向け設備投資が再開。
- 当社25/3期は、すべてのアプリケーション向けで装置販売が伸長し、サービスビジネスも伸長したことから、前期比で増収増益。

2026年3月期連結業績予想

- 先端DRAM、先端ノードLogic/Foundryに対する積極的な設備投資に続いて、NAND向け設備投資が進む見通し。
- 当社では、先端デバイス向けを中心に世界各国向け売上が増加、中国地場向け売上は減少し、中国地場売上比率は平常化。米中貿易摩擦や各国関税政策による間接的な影響を想定し、業績予想は慎重な見方で策定。

連結業績サマリー

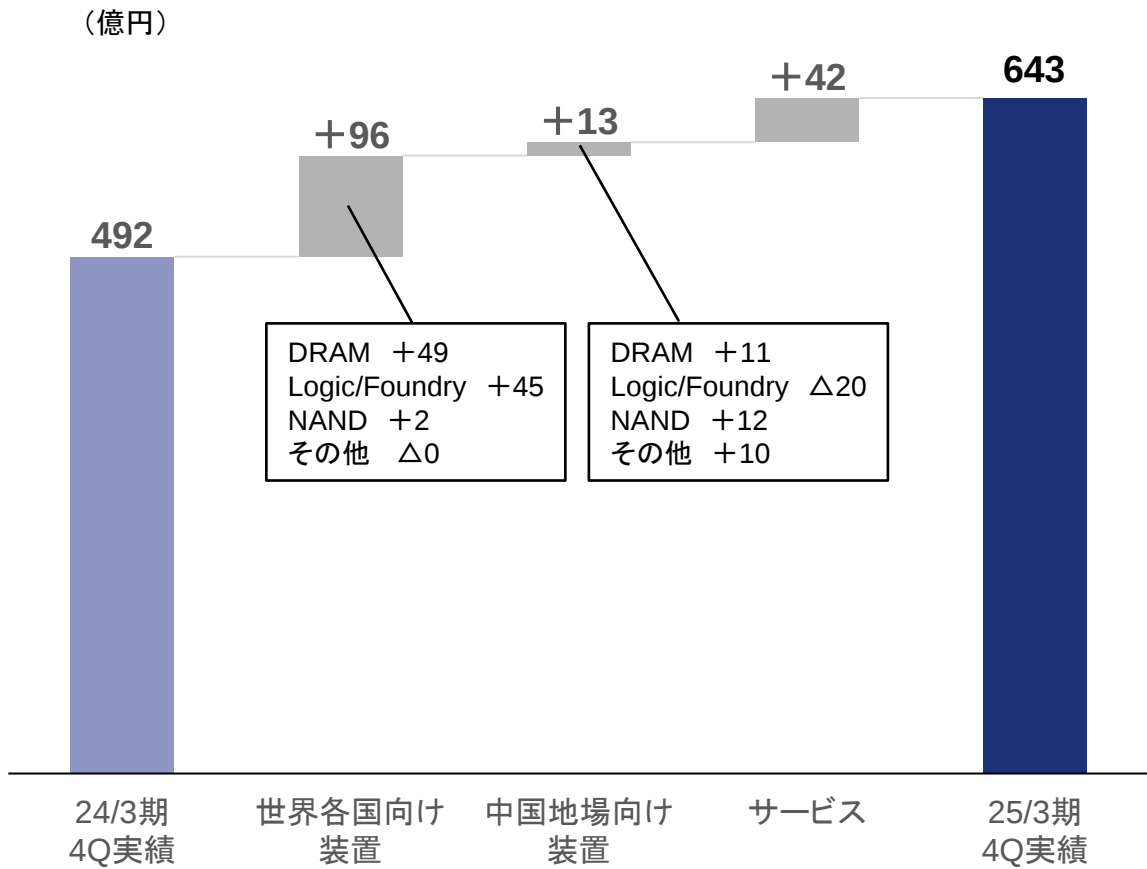
4Qは、売上、利益、利益率ともに予想を上回り、前年同期比で増収増益。
通期でも、前期比で増収増益となり、各利益率も上昇。1円増配。

(億円)	24/3期					25/3期							
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	前年同期比	通期	前期比	従来予想
売上収益	327	450	540	492	1,808	652	493	601	643	+ 30.7%	2,389	+ 32.1%	2,380
売上総利益	143	199	217	191	750	294	220	249	255	+ 33.9%	1,017	+ 35.7%	1,009
売上総利益率	43.6%	44.2%	40.3%	38.8%	41.5%	45.0%	44.6%	41.4%	39.7%	+ 0.9pts	42.6%	+ 1.1pts	42.4%
調整後営業利益	56	110	124	88	378	194	113	139	132	+ 50.1%	578	+ 52.6%	566
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	23.0%	17.9%	20.9%	29.7%	22.9%	23.1%	20.5%	+ 2.7pts	24.2%	+ 3.2pts	23.8%
調整後当期(四半期)利益	38	73	91	71	273	143	73	96	111	+ 55.4%	423	+ 55.0%	396
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	16.9%	14.5%	15.1%	22.0%	14.7%	16.0%	17.2%	+ 2.7pts	17.7%	+ 2.6pts	16.7%
営業利益	40	94	107	67	307	179	96	123	116	+ 73.7%	513	+ 66.9%	502
営業利益率	12.2%	20.9%	19.8%	13.6%	17.0%	27.4%	19.4%	20.4%	18.1%	+ 4.5pts	21.5%	+ 4.5pts	21.1%
税引前当期(四半期)利益	37	91	107	61	298	177	102	112	116	+ 88.9%	508	+ 70.7%	501
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	19.9%	12.5%	16.5%	27.2%	20.7%	18.7%	18.1%	+ 5.6pts	21.3%	+ 4.8pts	21.1%
当期(四半期)利益	27	62	79	56	224	133	48	80	99	+ 76.1%	360	+ 60.9%	333
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	14.7%	11.5%	12.4%	20.4%	9.6%	13.3%	15.5%	+ 4.0pts	15.1%	+ 2.7pts	14.0%
研究開発費	29	30	31	37	127	33	39	38	46	+ 25.0%	156	+ 23.0%	-
設備投資額	51	21	105	28	205	112	30	25	36	+ 28.1%	203	△ 0.5%	-
減価償却費	26	27	28	28	109	29	30	33	34	+ 18.0%	126	+ 15.3%	-
1株当たり配当金(円)	-	-	-	11	11 ^{*1}	-	18	-	19	+ 8円	37	+ 26円	36

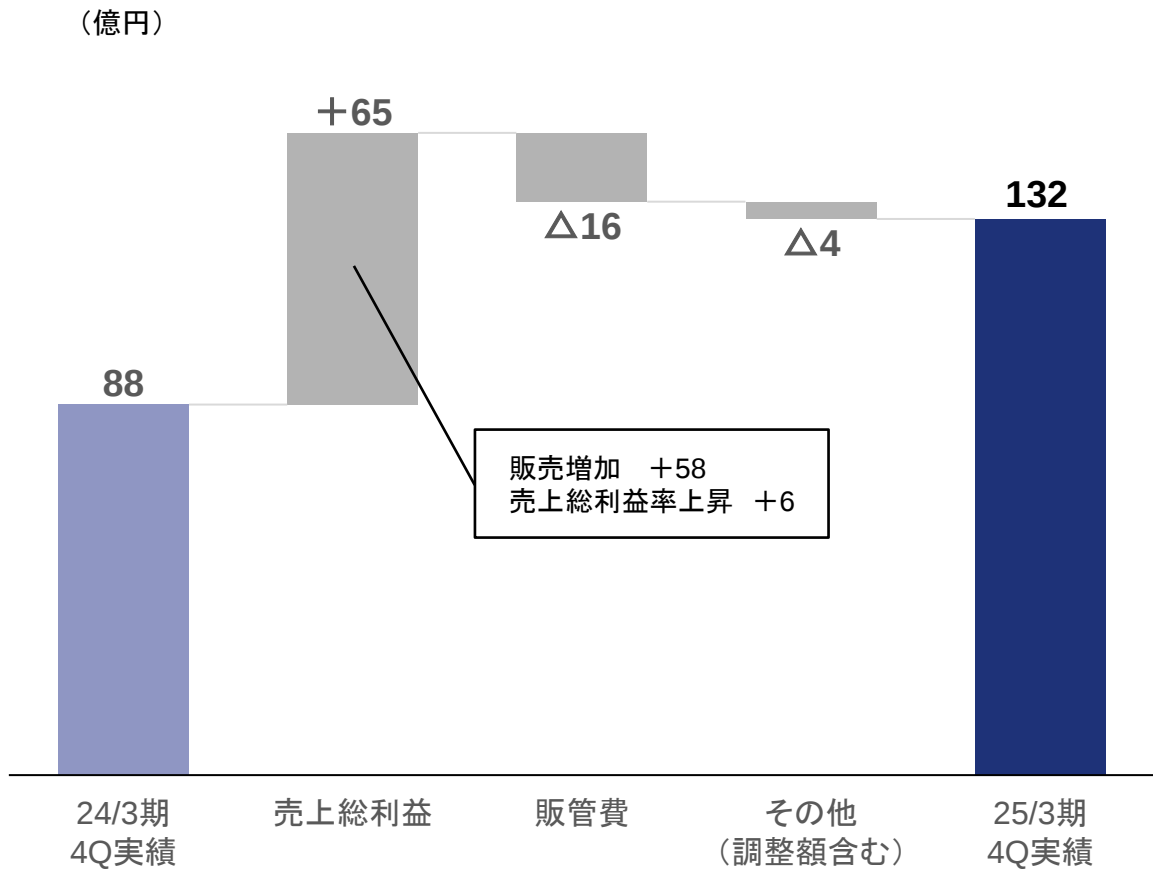
2025年3月期第4四半期実績 増減要因

4Qは、装置、サービスともに前年同期比で売上が増加し、全体の売上収益は前年同期比31%増。
販売増加と利益率上昇による売上総利益の増加により、調整後営業利益は前年同期比50%増。

売上収益

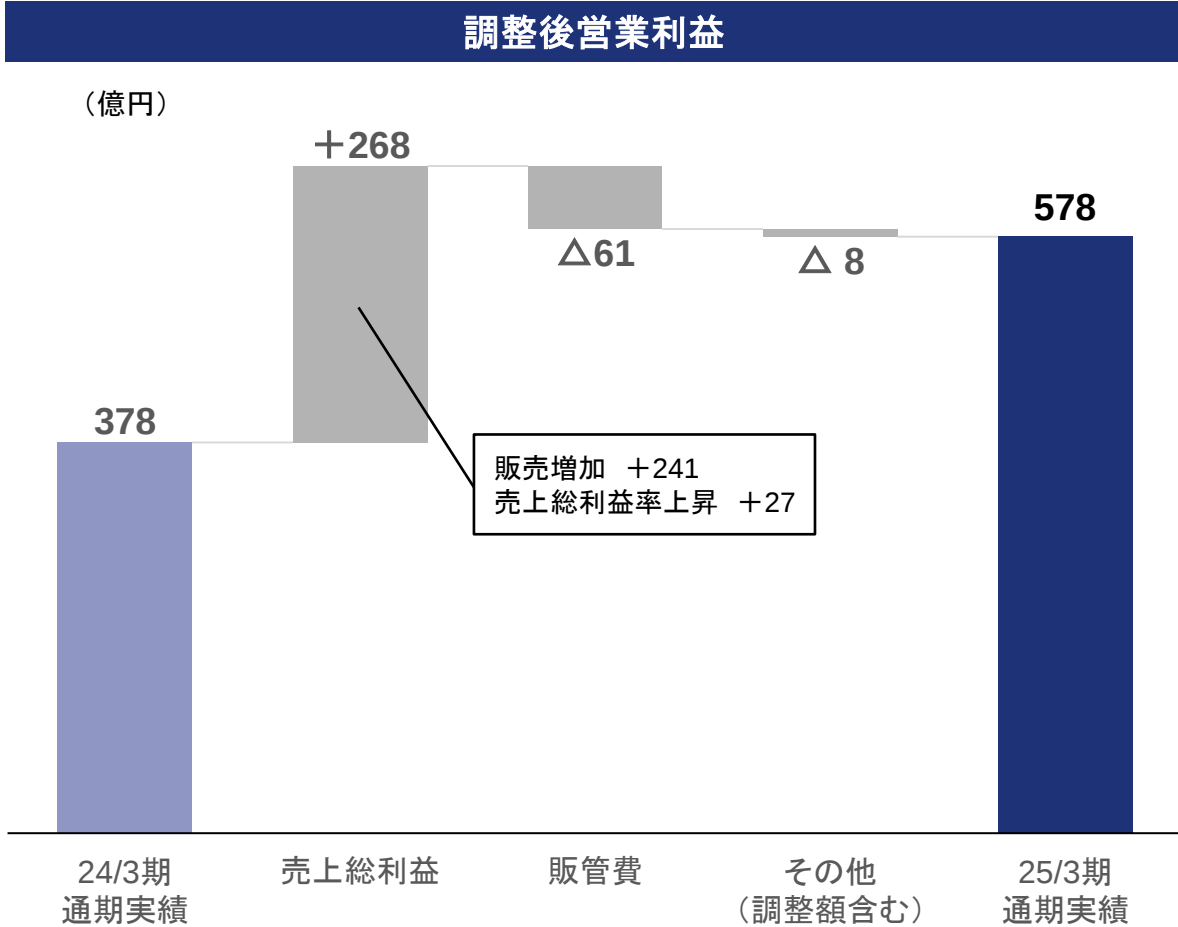
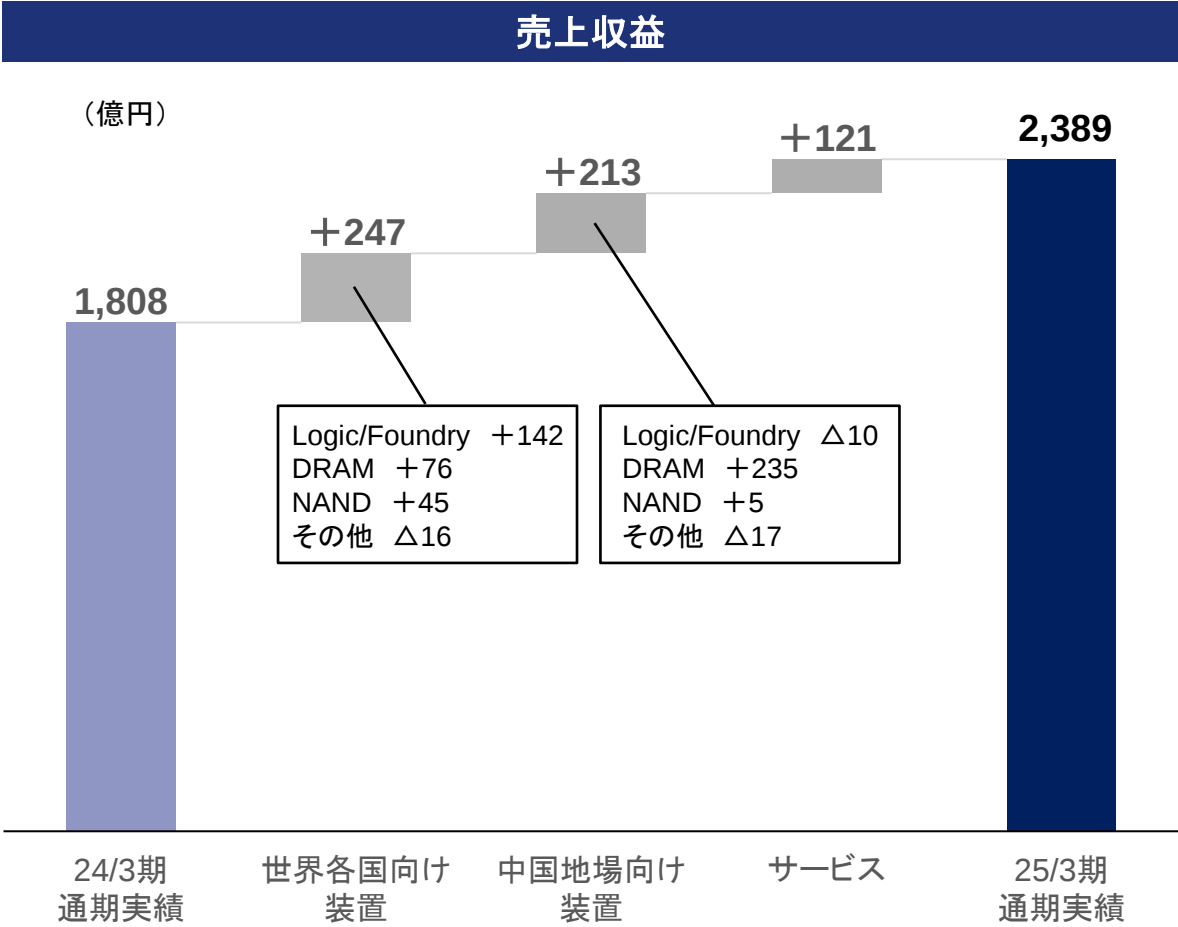


調整後営業利益



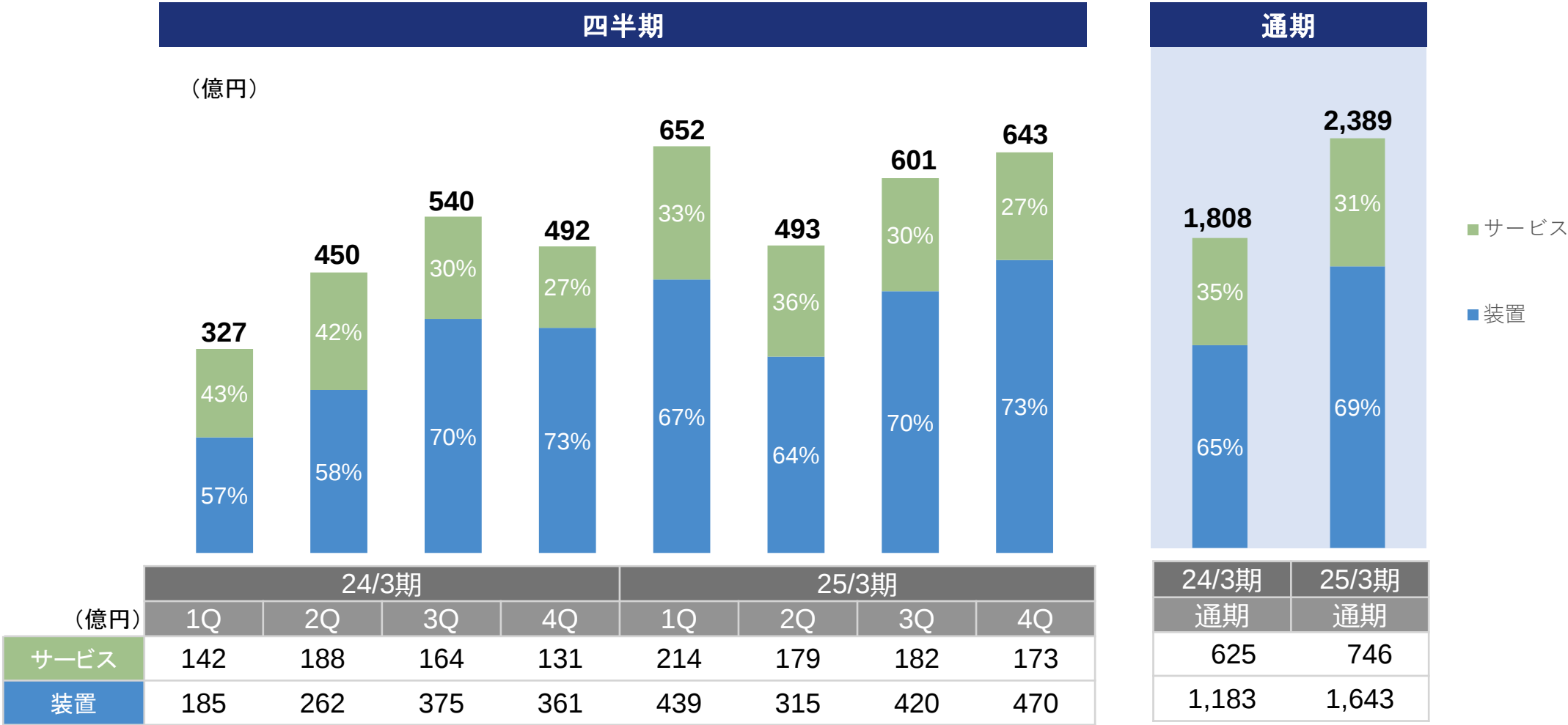
2025年3月期通期業績 増減要因

通期では、世界各国向け装置売上、中国地場向け装置売上、サービス売上ともに増加し、前期比32%増。
調整後営業利益は、販売増加と利益率向上により、前期比53%増。



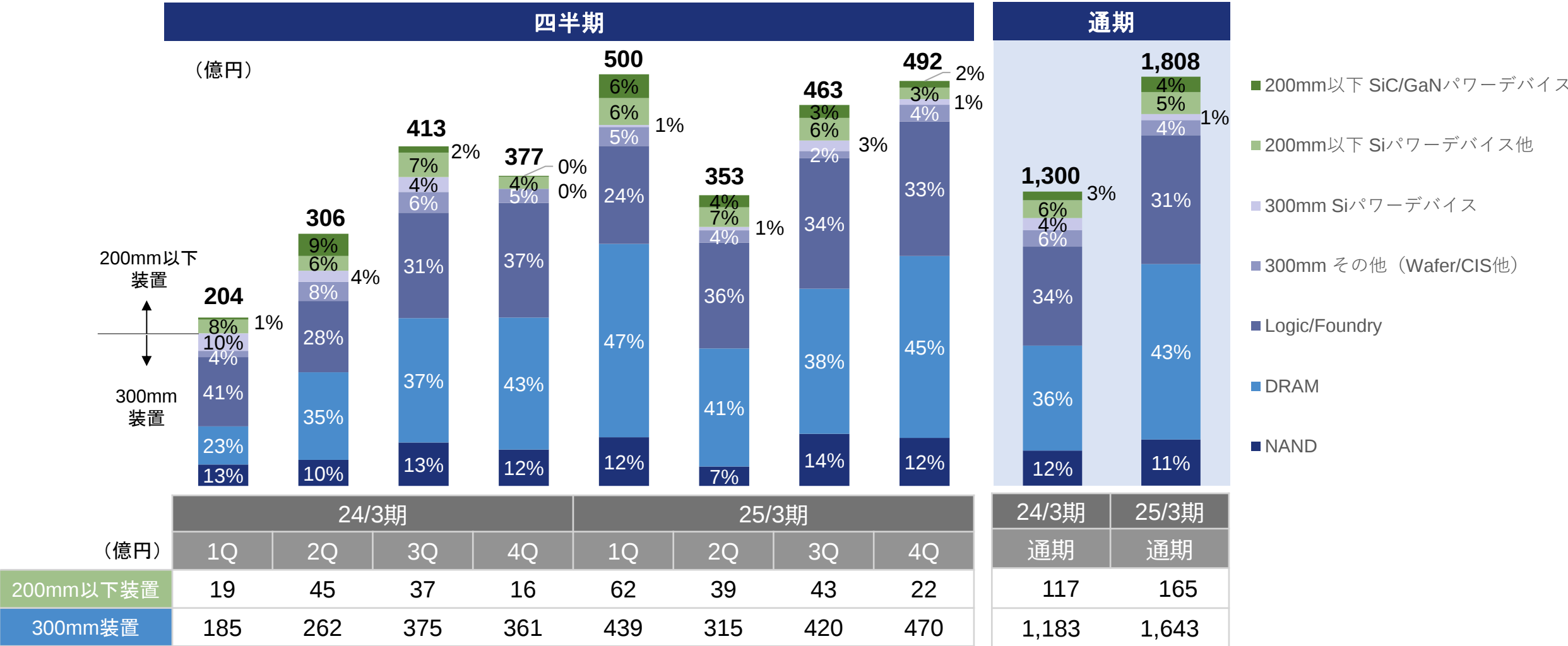
四半期別売上収益 ビジネス別

4Qは、前年同期比で装置売上30%増、サービス売上32%増。前四半期比では装置売上の増加が顕著。
通期では、前期比で装置売上39%増、サービス売上19%増。売上構成比は平常化へ前進。



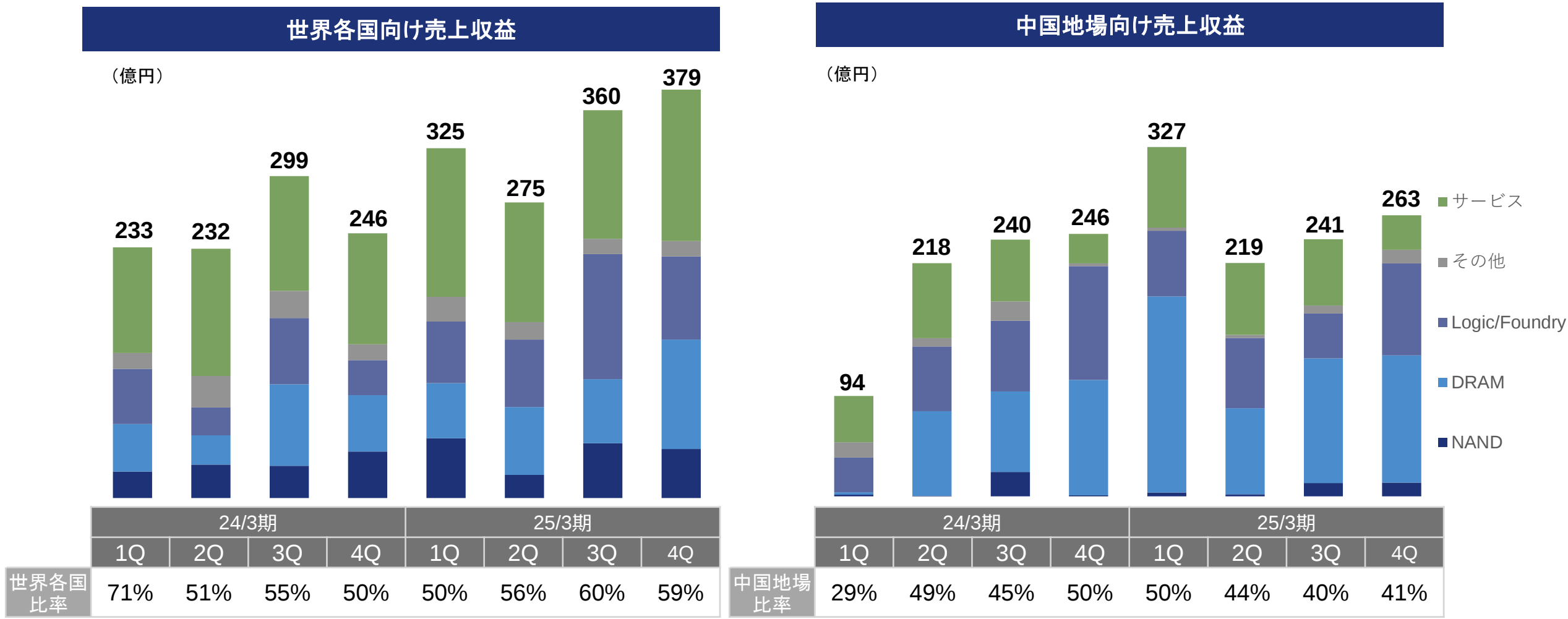
四半期別売上収益 アプリケーション別 (300mm装置 + 200mm以下装置)

4Qは、前年同期比でDRAM向け38%増、NAND向け32%増、Logic/Foundry向け17%増。前四半期比ではDRAM向けが伸長。通期では、DRAM向け67%増、NAND向け32%増、Logic/Foundry向け30%増。



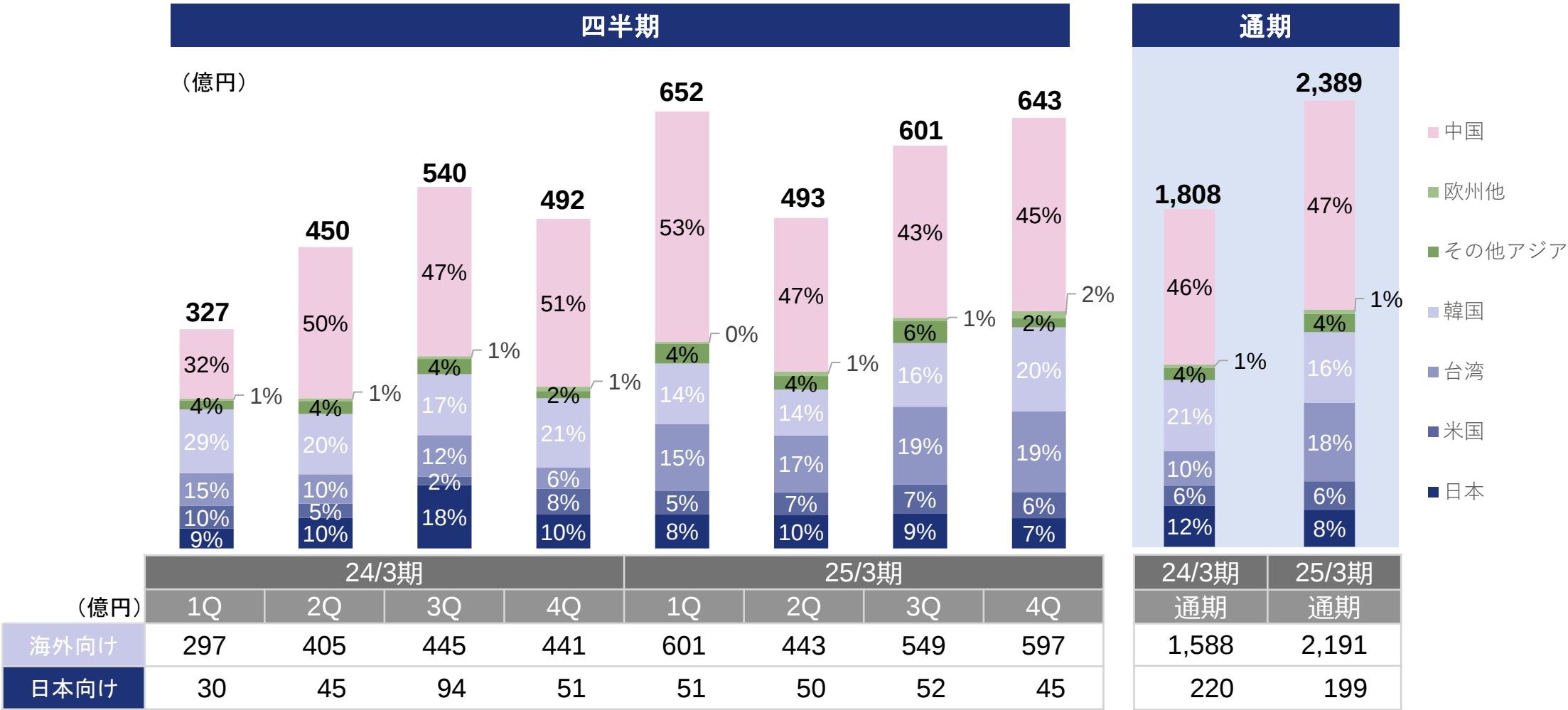
四半期別売上収益 世界各国向け・中国市場向け別

世界各国向け売上は回復基調が継続、中国市場向け売上は1Q出荷集中の反動から回復。
それぞれ4Qは前四半期比で増収。中国市場向け売上比率は40%程度に低下。



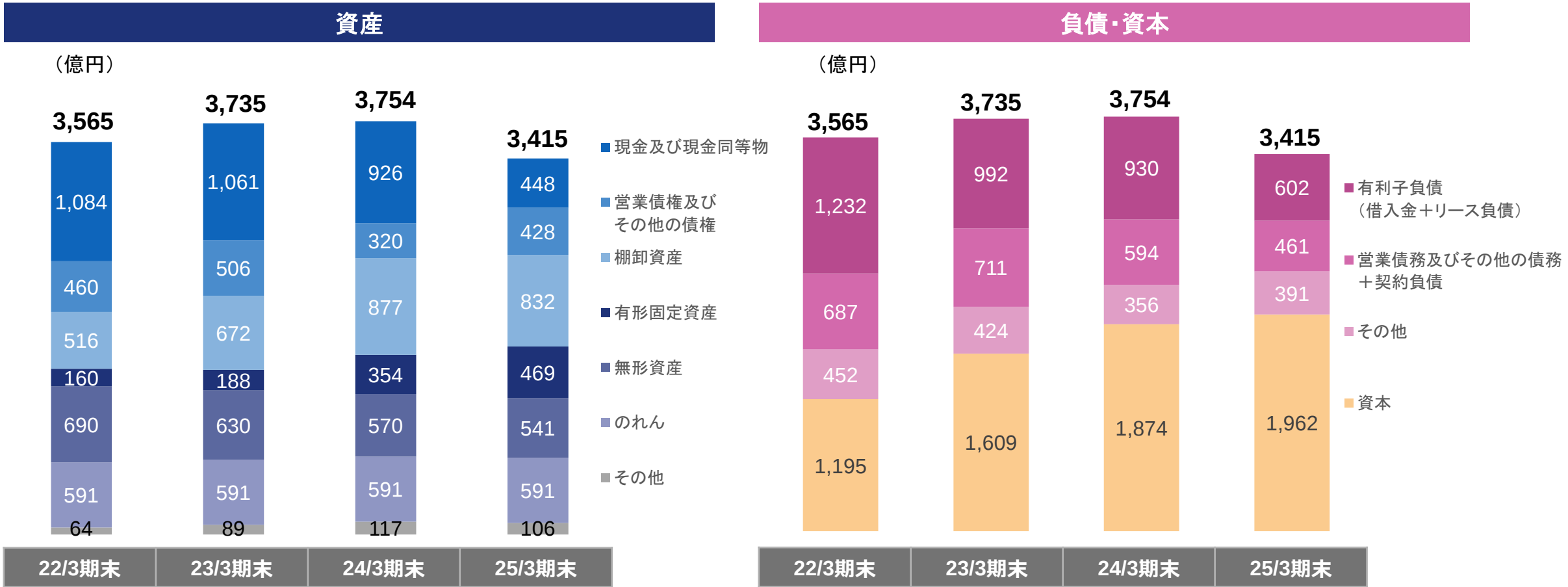
四半期別売上収益 地域別(仕向地別)

仕向地別では、台湾向け、韓国向けが増加基調。通期では前期比で台湾向けが増加。



貸借対照表

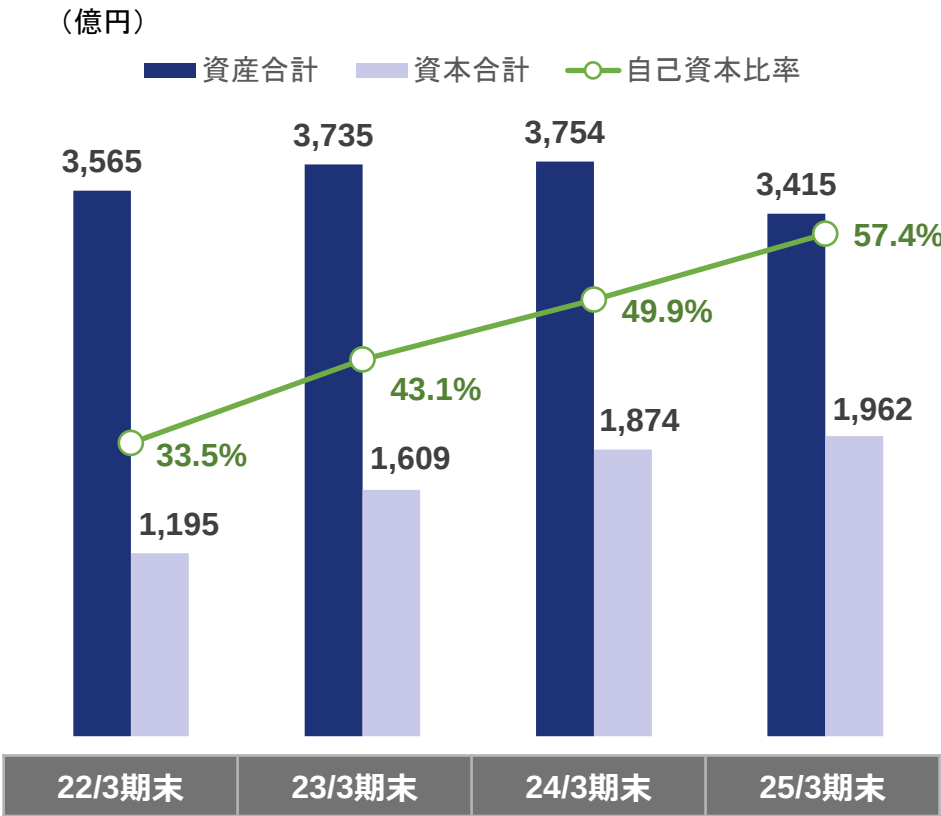
資産合計は、借入金^①の期限前返済、自己株式^②の取得による現金等の減少により、前期末比で339億円減少。
負債合計は、借入金^①の返済、営業債務等の減少により、前期末比で427億円減少。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で88億円増加。



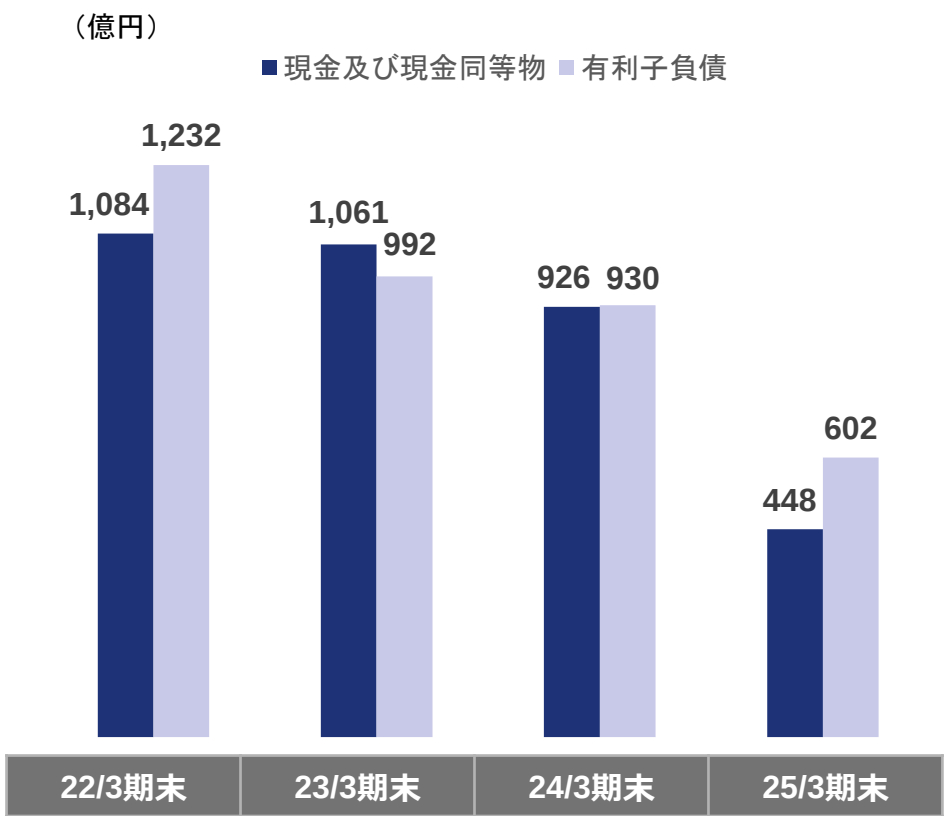
自己資本比率 & 現金及び現金同等物／有利子負債

当期末の自己資本比率は57%に上昇。当期末のネットデットは自己株式の取得による現金の支出等で154億円に増加したものの、借入金は期限前返済により333億円減少。

資産合計／資本合計／自己資本比率

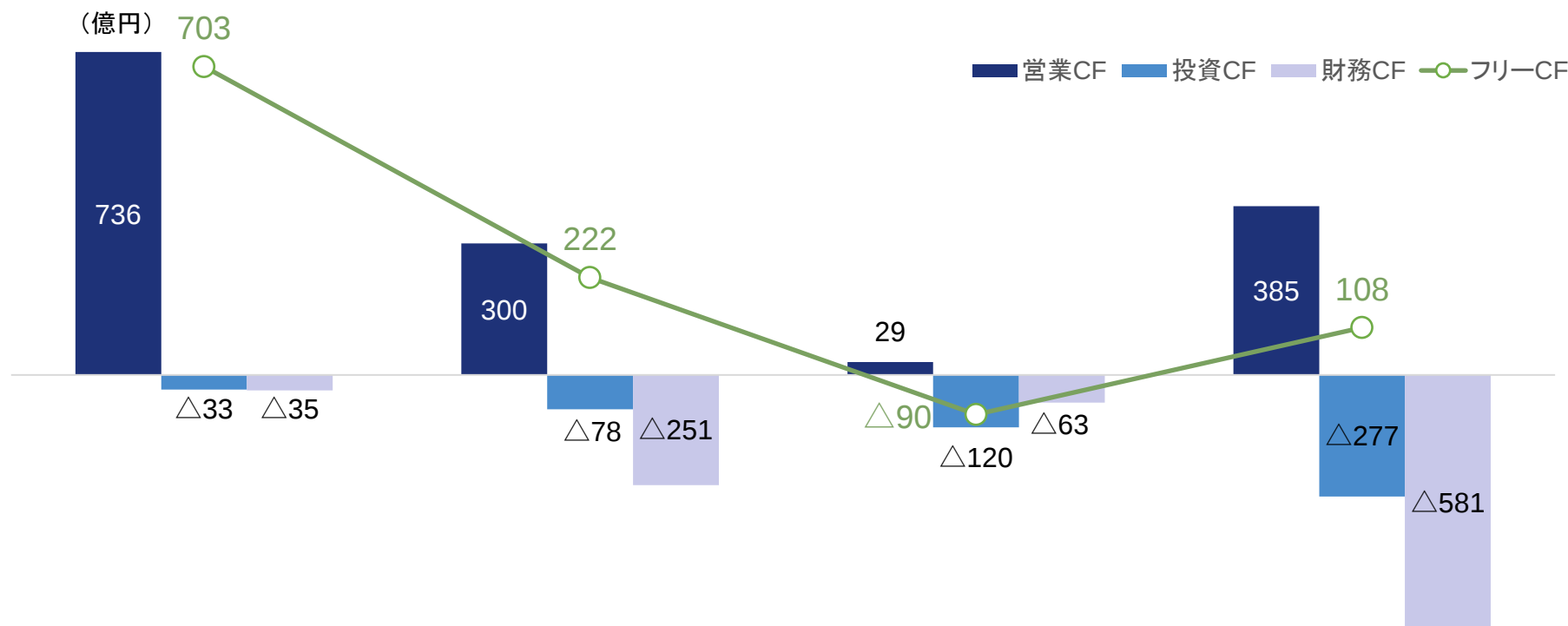


現金及び現金同等物／有利子負債



キャッシュ・フロー

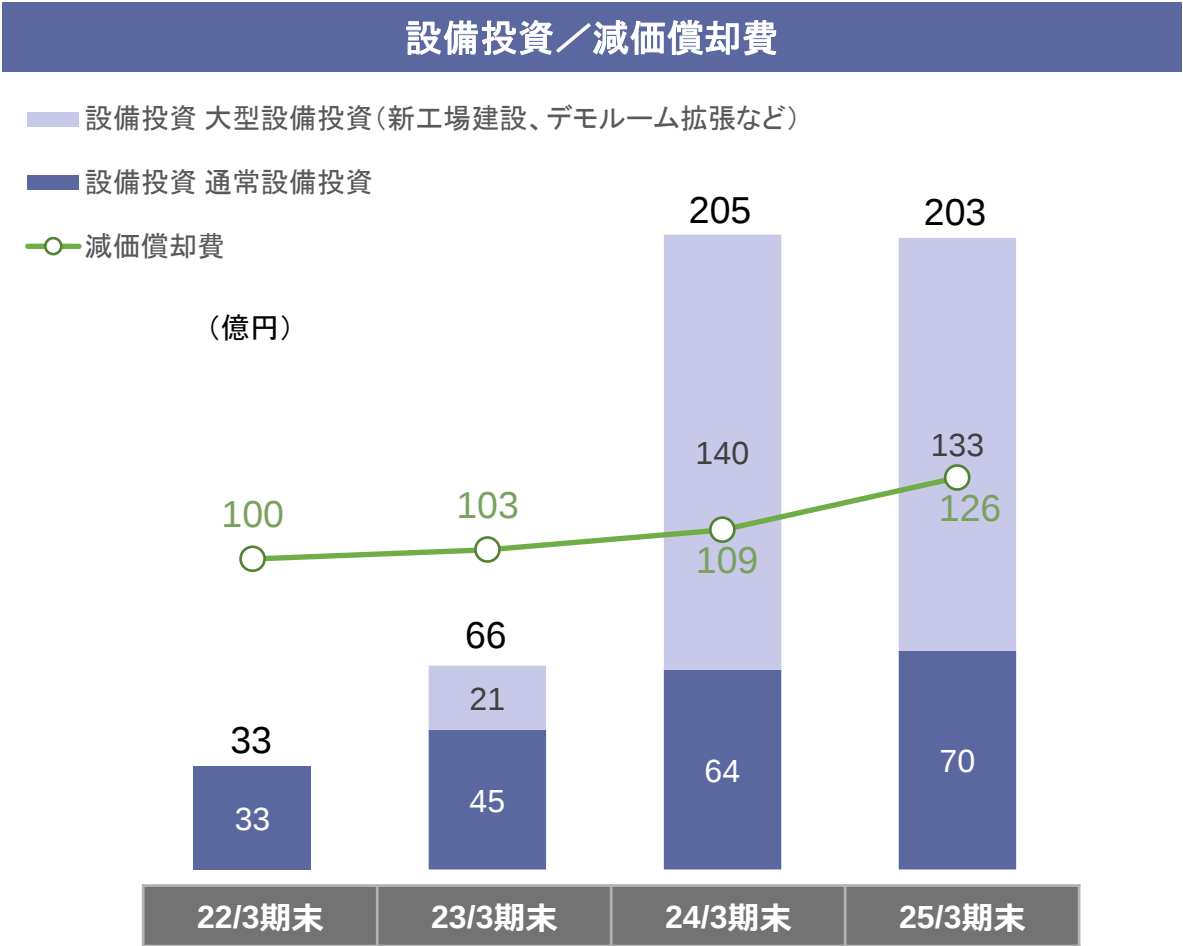
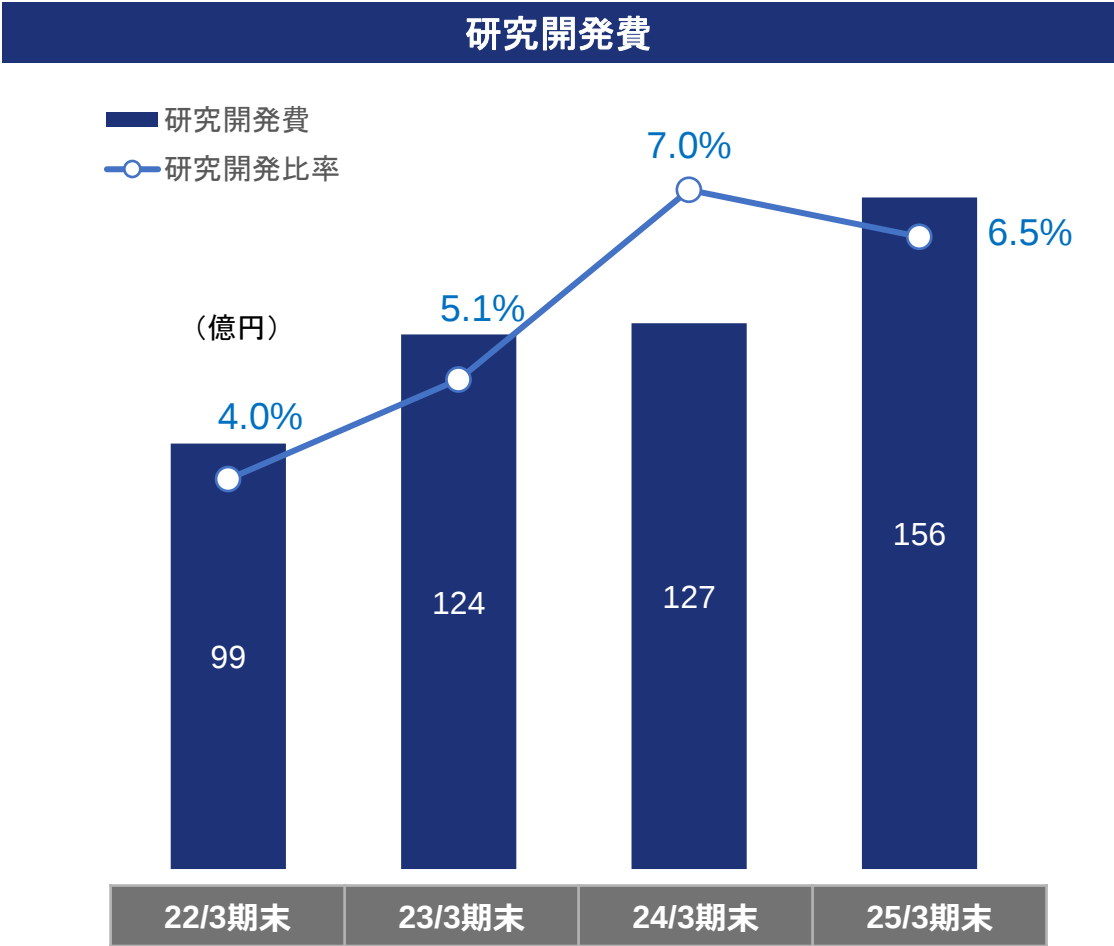
売上収益増加による営業CFが有形固定資産取得による投資CFの支出を上回り、フリーCFは108億円。
財務CFは借入金の期限前返済と自己株式の取得による支出等により、581億円の支出。



(億円)	22/3期	23/3期	24/3期	25/3期
営業CF	736	300	29	385
投資CF	△33	△78	△120	△277
財務CF	△35	△251	△63	△581
フリーCF	703	222	△90	108
現金及び現金同等物残高	1,084	1,061	926	448

研究開発費／設備投資／減価償却費

中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。
研究開発費は前期比2割増。設備投資は2年続いた大型設備投資が完了、減価償却費は前期比2割増。





2026年3月期連結業績予想

2025年3月期連結決算概要

- 生成AIの普及を背景に先端DRAM向け設備投資が活発。Logic/Foundry向け設備投資は成熟ノード向けに落ち着きが見られるものの、先端ノード向けが増加。NAND向け設備投資が再開。
- 当社25/3期は、すべてのアプリケーション向けで装置販売が伸長し、サービスビジネスも伸長したことから、前期比で増収増益。

2026年3月期連結業績予想

- 先端DRAM、先端ノードLogic/Foundryに対する積極的な設備投資に続いて、NAND向け設備投資が進む見通し。
- 当社では、先端デバイス向けを中心に世界各国向け売上が増加、中国地場向け売上は減少し、中国地場売上比率は平常化。米中貿易摩擦や各国関税政策による間接的な影響を想定し、業績予想は慎重な見方で策定。

2026年3月期業績・配当予想

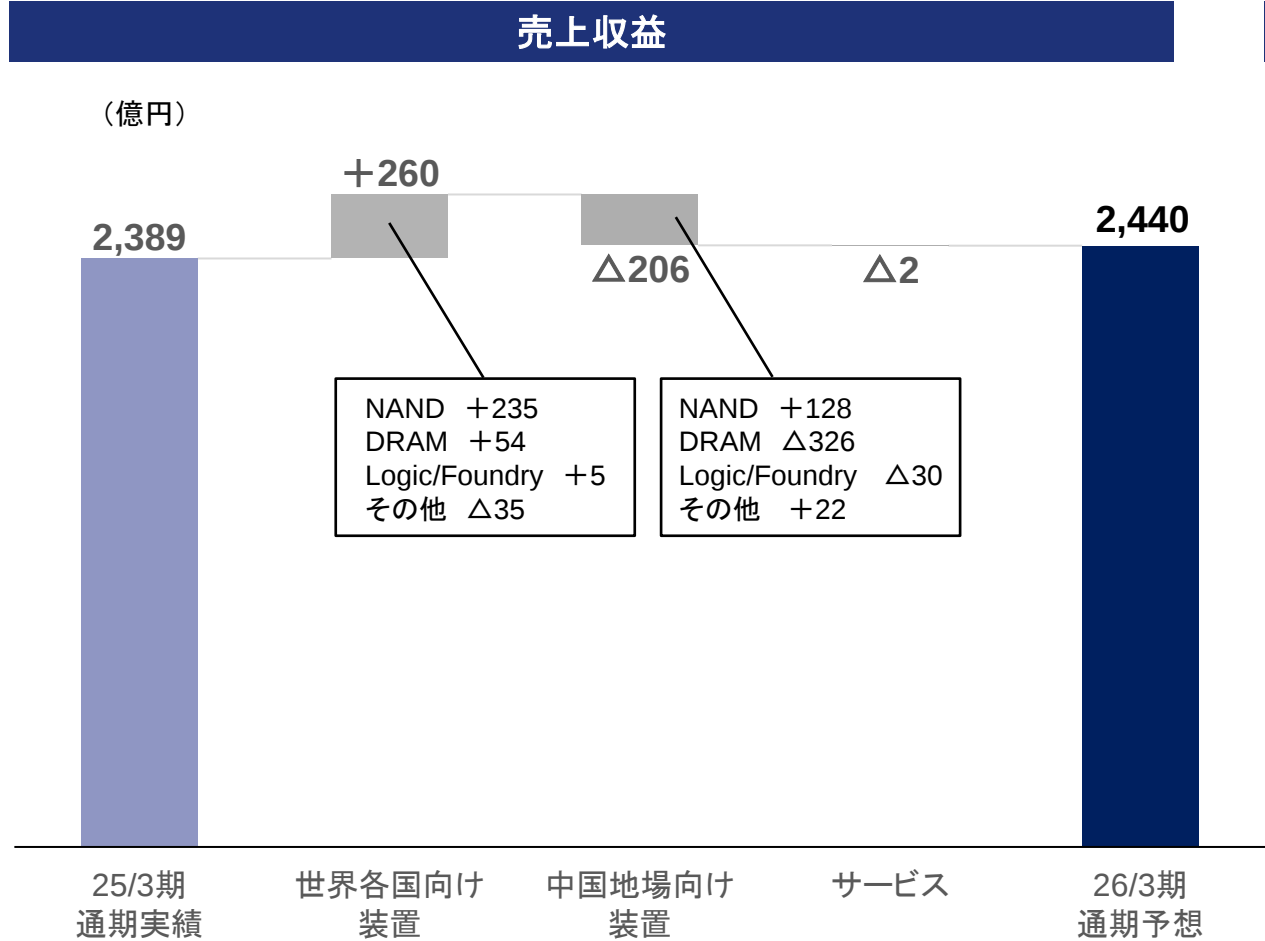
各国関税政策による間接的な影響を想定し、25/3期比で売上収益は増加、先行投資で調整後営業利益、調整後当期利益は微減。配当金は調整後当期利益ベースの配当性向20%超の年間36円を予想。

(億円)	25/3期			26/3期			
	上期実績	下期実績	通期実績	上期予想	下期予想	通期予想	前期比
売上収益	1,145	1,244	2,389	1,040	1,400	2,440	+2.1%
売上総利益	514	504	1,017	441	603	1,044	+2.7%
売上総利益率	44.8%	40.5%	42.6%	42.3%	43.2%	42.8%	+0.2pts
調整後営業利益	307	271	578	200	353	552	△4.4%
調整後営業利益率	26.8%	21.8%	24.2%	19.2%	25.1%	22.6%	△1.6pts
調整後当期(半期)利益	216	207	423	140	260	401	△5.2%
調整後当期(半期)利益率	18.9%	16.6%	17.7%	13.5%	18.6%	16.4%	△1.3pts
営業利益	274	239	513	170	322	492	△4.1%
営業利益率	24.0%	19.2%	21.5%	16.3%	23.0%	20.2%	△1.3pts
税引前当期(半期)利益	279	228	508	165	319	484	△4.7%
税引前当期(半期)利益率	24.4%	18.4%	21.3%	15.9%	22.8%	19.8%	△1.5pts
当期(半期)利益	181	180	360	119	240	360	△0.0%
当期(半期)利益率	15.8%	14.4%	15.1%	11.4%	17.2%	14.7%	△0.3pts
1株当たり配当金(円)	18	19	37	18	18	36	△1円
配当性向(調整後当期利益ベース)	—	—	20.4%	—	—	20.9%	+0.5%

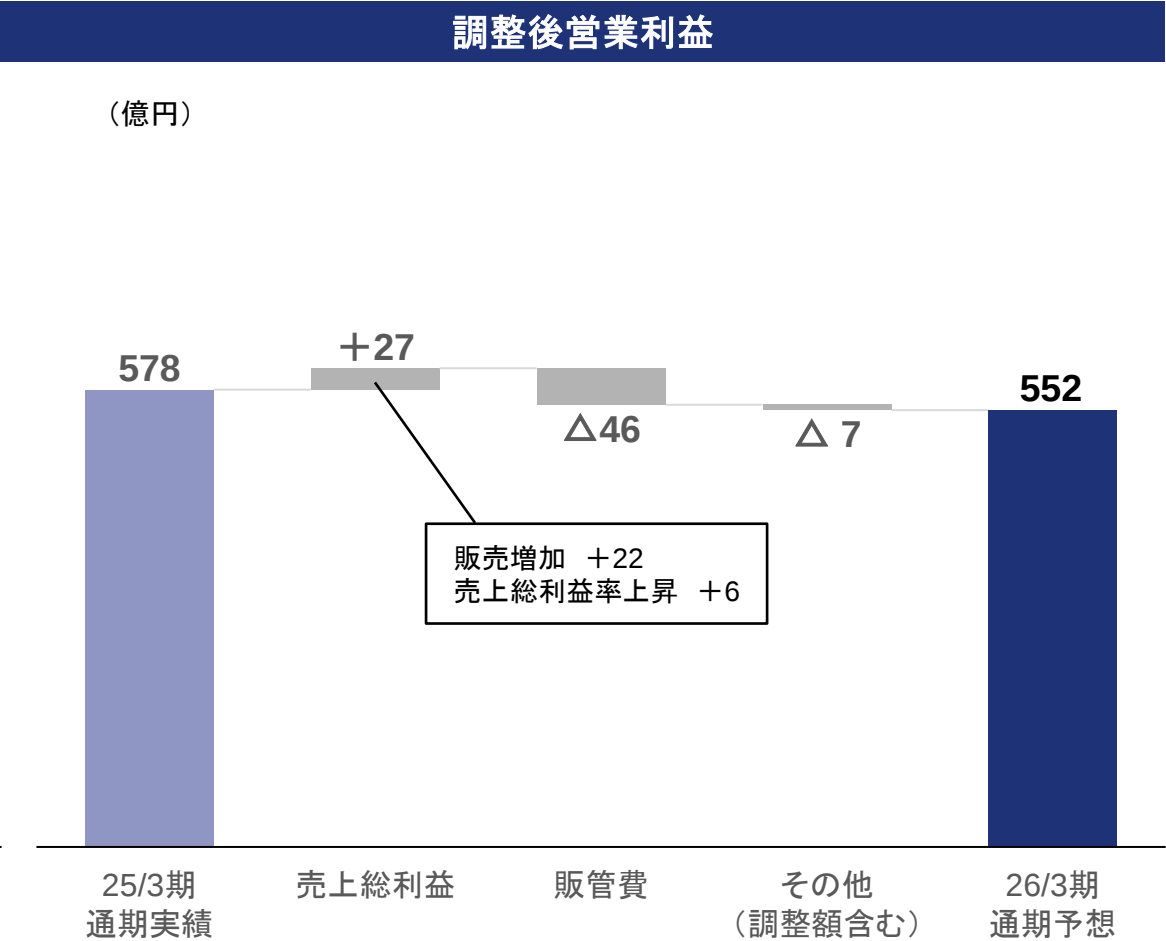
2026年3月期業績予想 増減要因

デバイスメーカーの生産規模拡大に向けた投資を慎重に見積もり、世代交代投資を中心に売上収益は前期比2%増を見込む。売上総利益率は上昇、調整後営業利益は先行投資による販管費増加により4%減を見込む。

売上収益



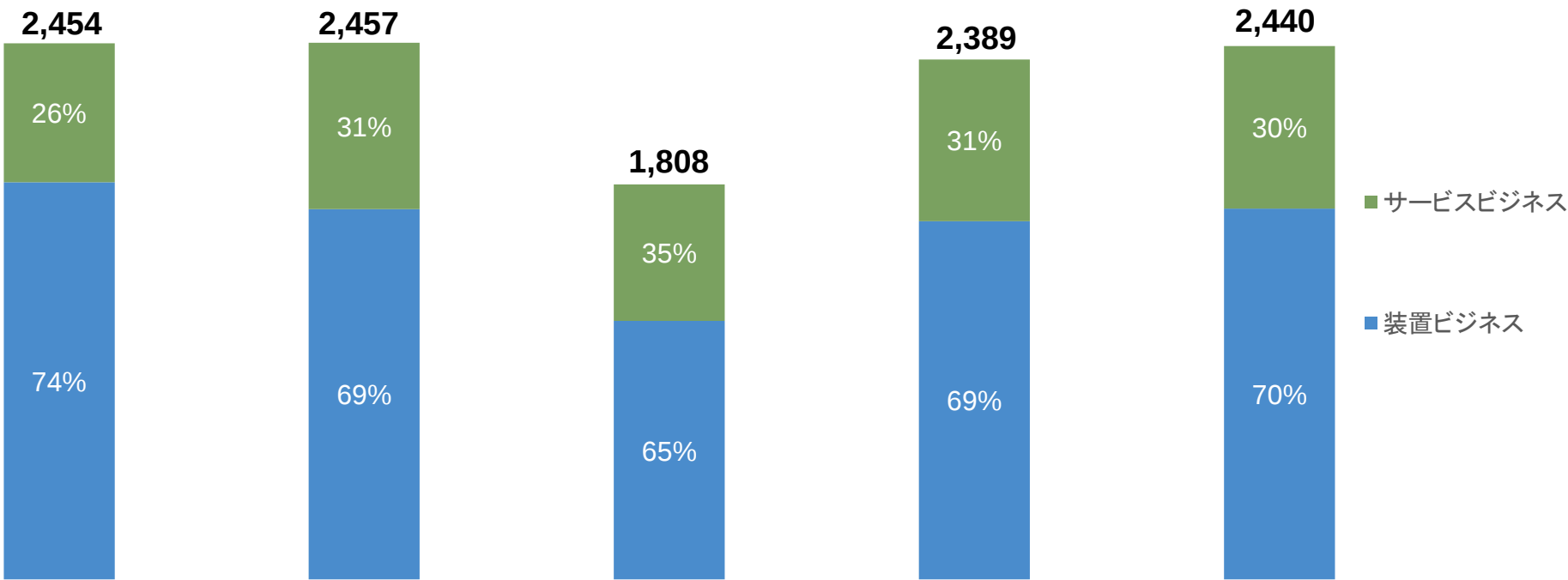
調整後営業利益



2026年3月期業績予想 ビジネス別売上収益

装置売上は前期比3%増、サービス売上は前期並みを見込む。
売上構成比は装置売上比率が70%まで回帰する見通し。

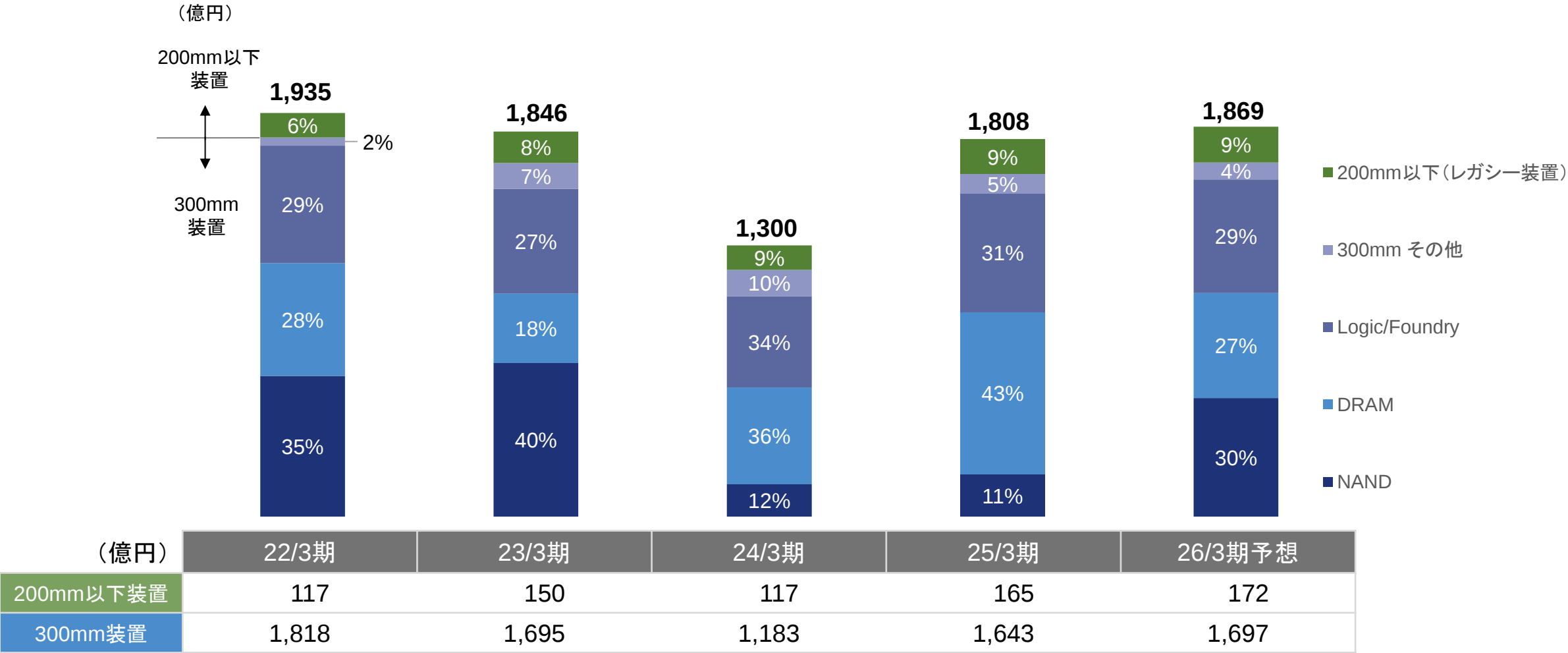
(億円)



(億円)	22/3期	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期予想
サービス	636	762	625	746	744
装置	1,818	1,695	1,183	1,643	1,697

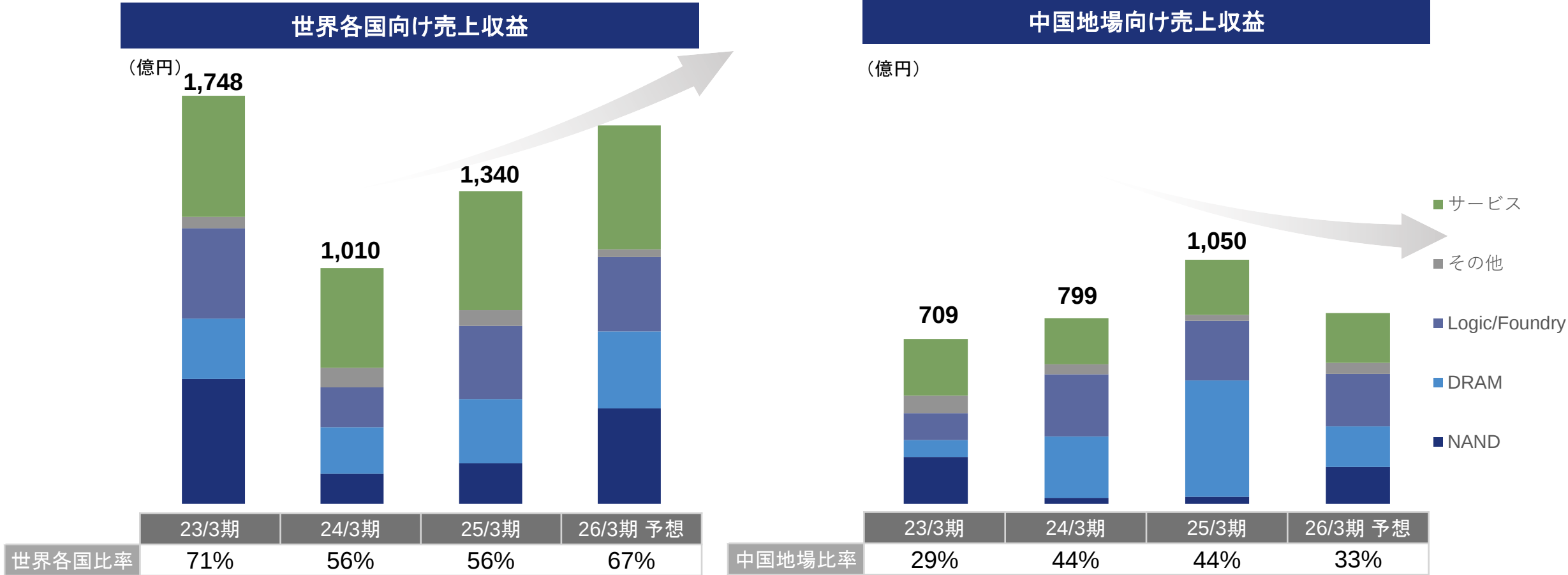
2026年3月期業績予想 アプリケーション別売上収益*1

前期比でDRAM向けは35%減、Logic/Foundry向けは微減を見込む一方、NAND向けが2.8倍の伸長、SiC/GaNパワーデバイス向けは5割増を見込む。



2026年3月期業績予想 世界各国向け・中国地場向け売上収益

世界各国向け売上は、先端DRAM向け、Logic GAA向けの伸長に加え、3D NAND向けの回復により、前期比22%増。中国地場向け売上は、DRAM向け投資の端境期にあたり前期比23%減少も、NAND向けは3期ぶりの販売回復を見込む。中国地場向け売上比率は33%に低下。

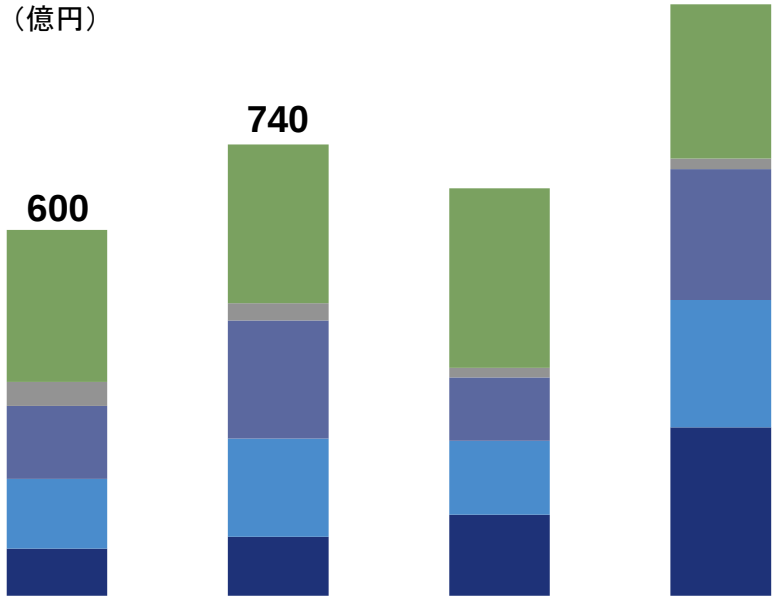


2026年3月期業績予想 上期・下期別売上収益

25/3期は上期に大型出荷が集中したのに対して、26/3期は下期に大型出荷が集中するため、
上期は前期比で減収減益の見込み。

世界各国向け売上収益

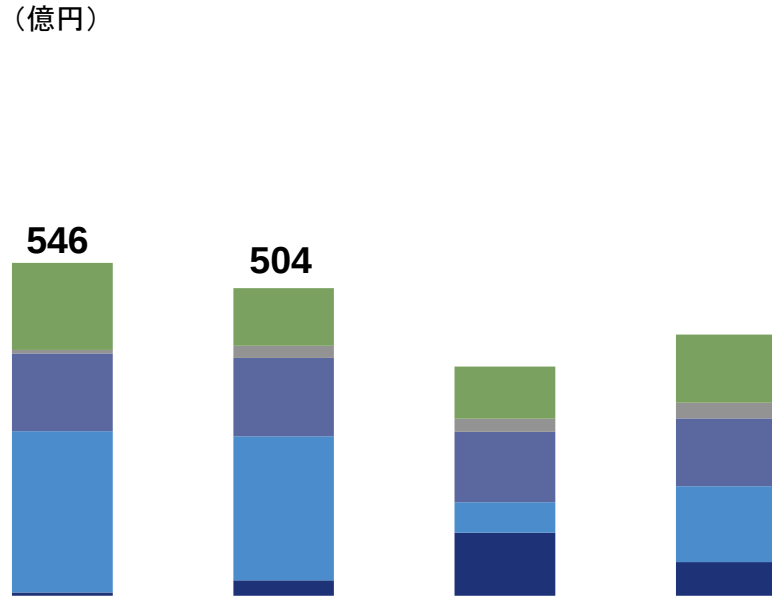
(億円)



	25/3期		26/3期	
	上期	下期	上期予想	下期予想
世界各国比率	52%	59%	64%	69%

中国地場向け売上収益

(億円)

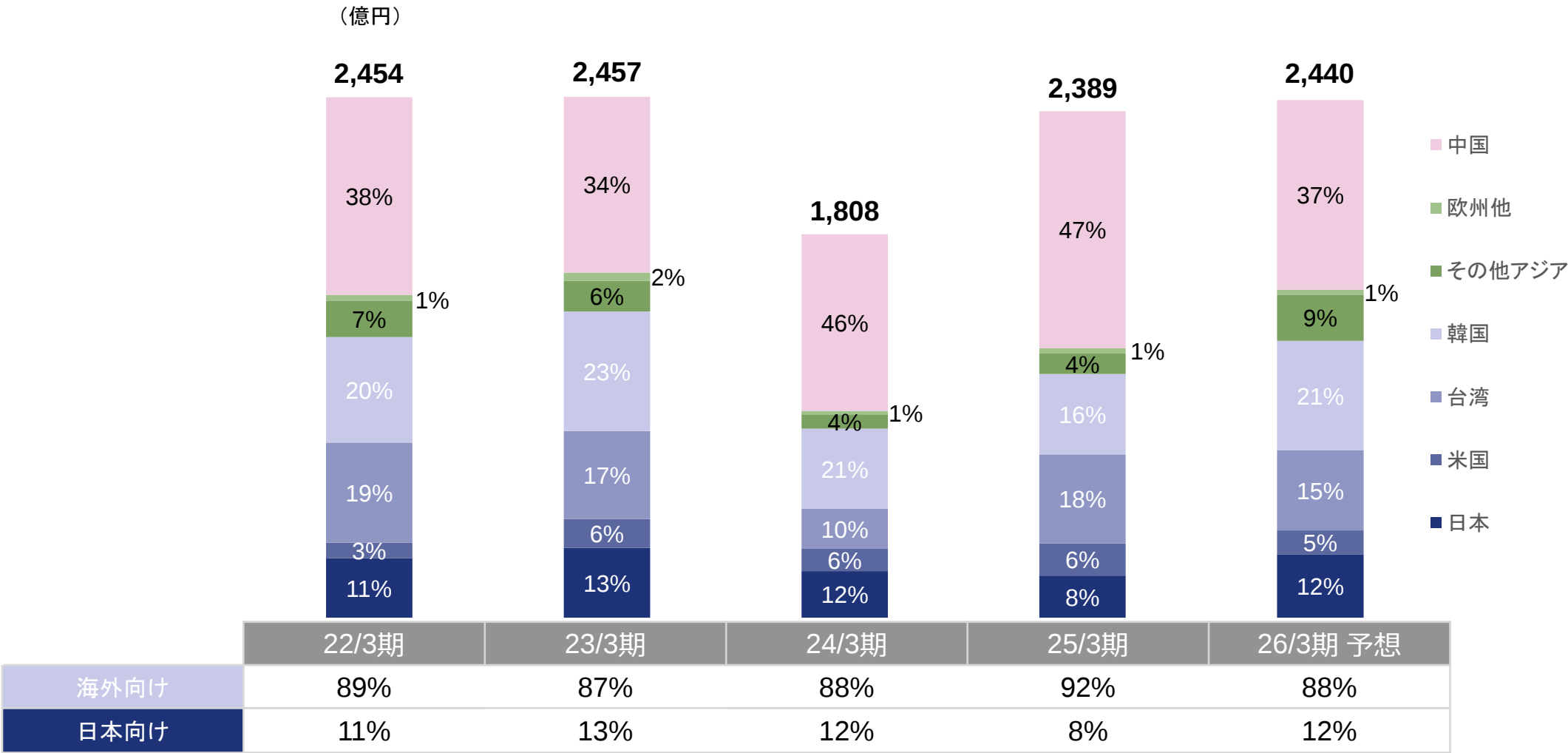


	25/3期		26/3期	
	上期	下期	上期予想	下期予想
中国地場比率	48%	41%	36%	31%

- サービス
- その他
- Logic/Foundry
- DRAM
- NAND

2026年3月期業績予想 地域別(仕向地別)売上収益

台湾・韓国仕向けは引き続き増加基調。米国仕向け比率は前期同様の5%を見込む。



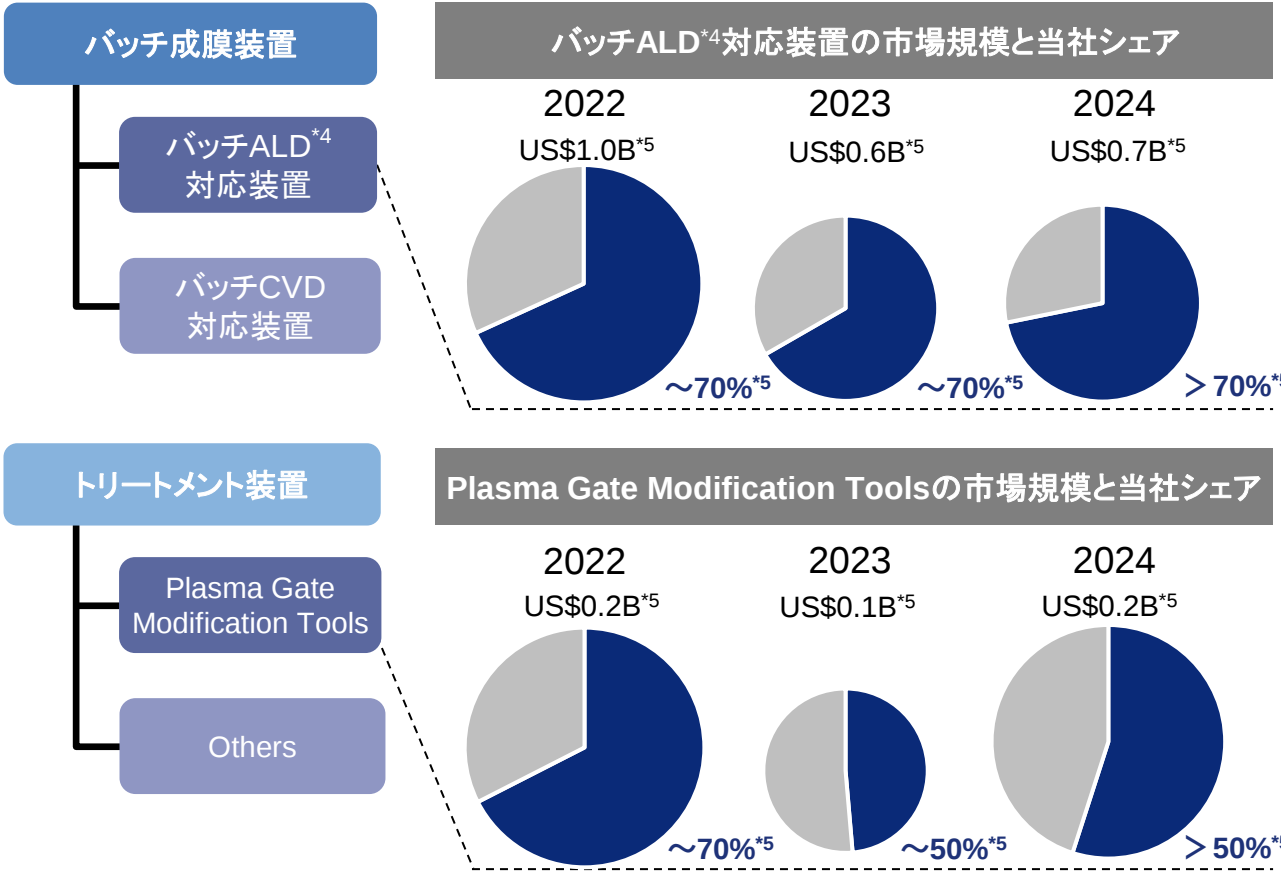
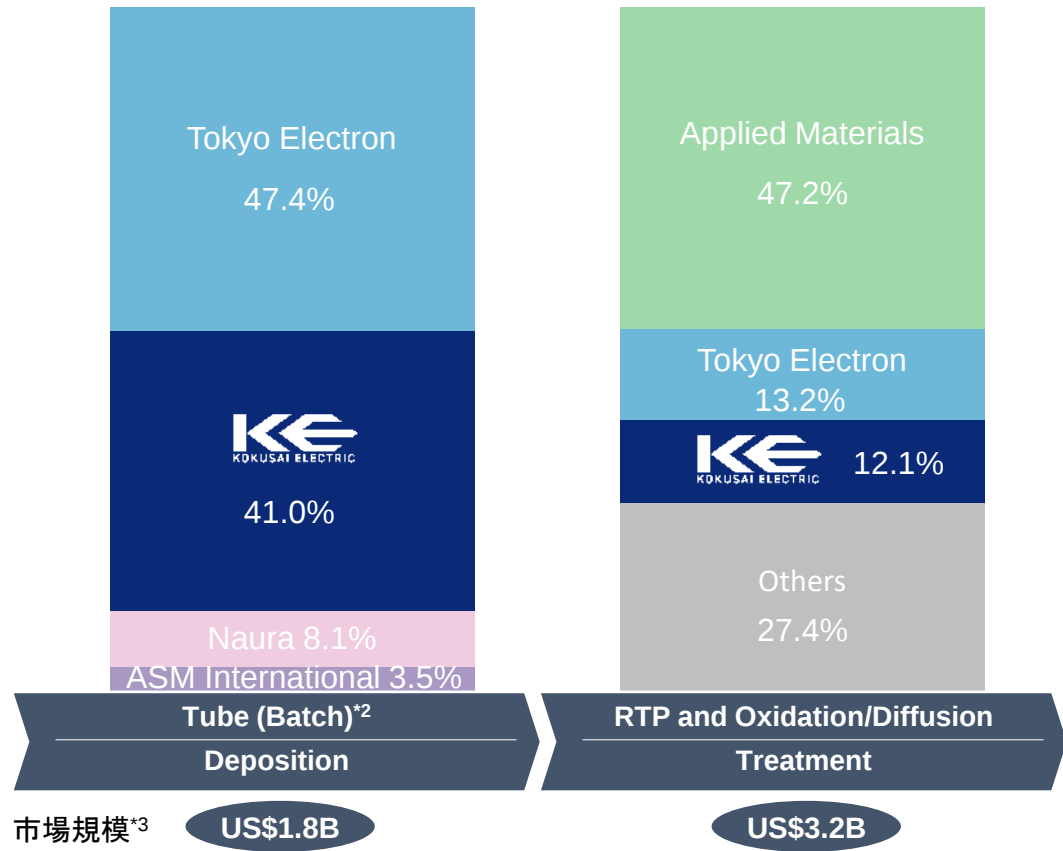


今後の取り組み

マーケットシェアの推移

CY24は、CY23比でバッチ成膜装置、枚葉トリートメント装置ともシェア回復。
バッチALD^{*4}対応装置シェアは70%超で過去最高、枚葉トリートメント装置シェアは50%超に上昇。

(CY24) Gartnerの分類に基づく市場シェア^{*1}



^{*1} 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment(トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。^{*2} GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義(当社にて算出) ^{*3} Gartnerによるカテゴリーの合計値 ^{*4} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます ^{*5} 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

事業環境の見通し

先端デバイスは好調も、成熟ノードLogic/Foundryの落ち着きや汎用メモリーの回復遅れをふまえ、CY25のWFEはCY24並みと予想、長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。

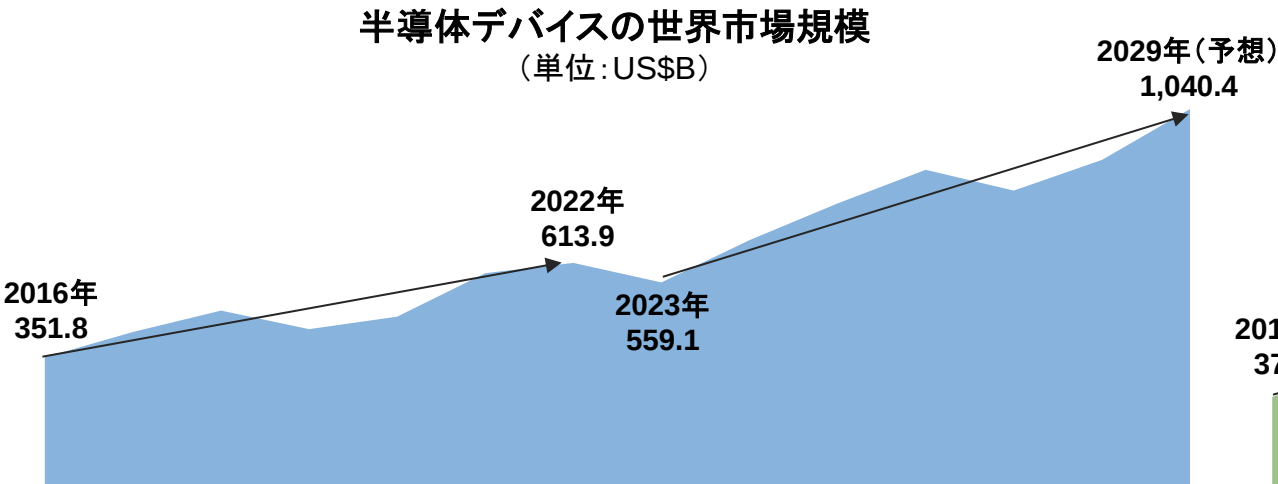
半導体デバイス市場

- 半導体デバイス市場では、生成AI関連の需要が引き続き市場をけん引し、汎用DRAMやNANDは回復に遅れ。
- 成熟ノード向けの活発な設備投資は落ち着き、中国では相応の規模が持続するものの、欧米では投資抑制が続く。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が期待される。

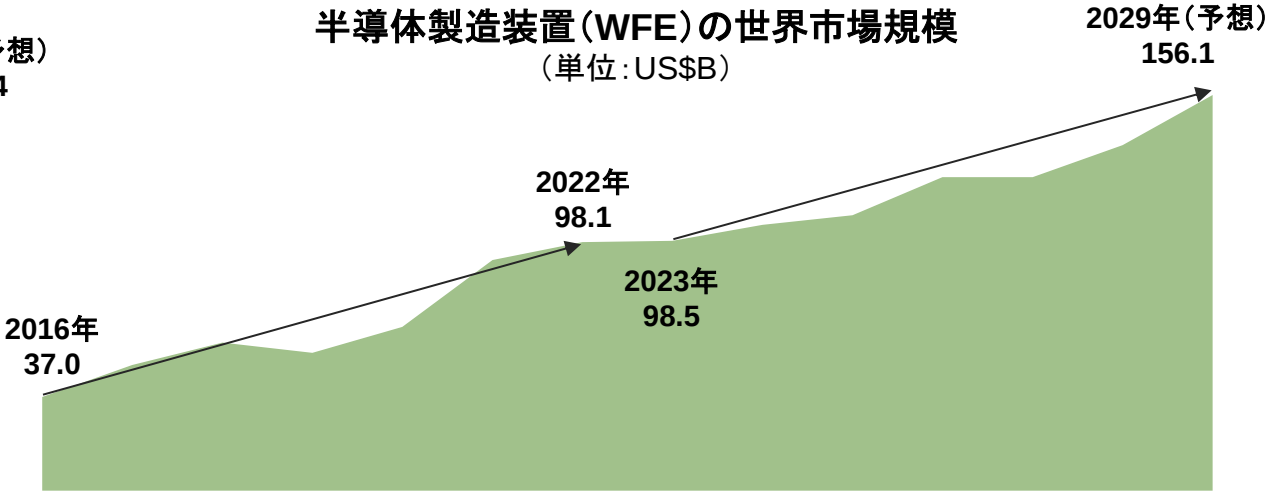
半導体製造装置(WFE)市場

- 先端デバイス向け装置需要が増加基調を持続。成熟ノード向け装置需要は落ち着き。
- WFEのCY25規模はCY24と同水準、うち世界各国向けは前年比10～20%増、中国地場向けは前年比20～30%減を見込む。
- 中長期的には大きな成長が期待され、今後数年で1,200億ドル程度まで成長するとの想定には変更なし。

半導体デバイスの世界市場規模
(単位:US\$B)



半導体製造装置(WFE)の世界市場規模
(単位:US\$B)



出所: TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 2025)
TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

アプリケーション別の事業環境と当社の状況

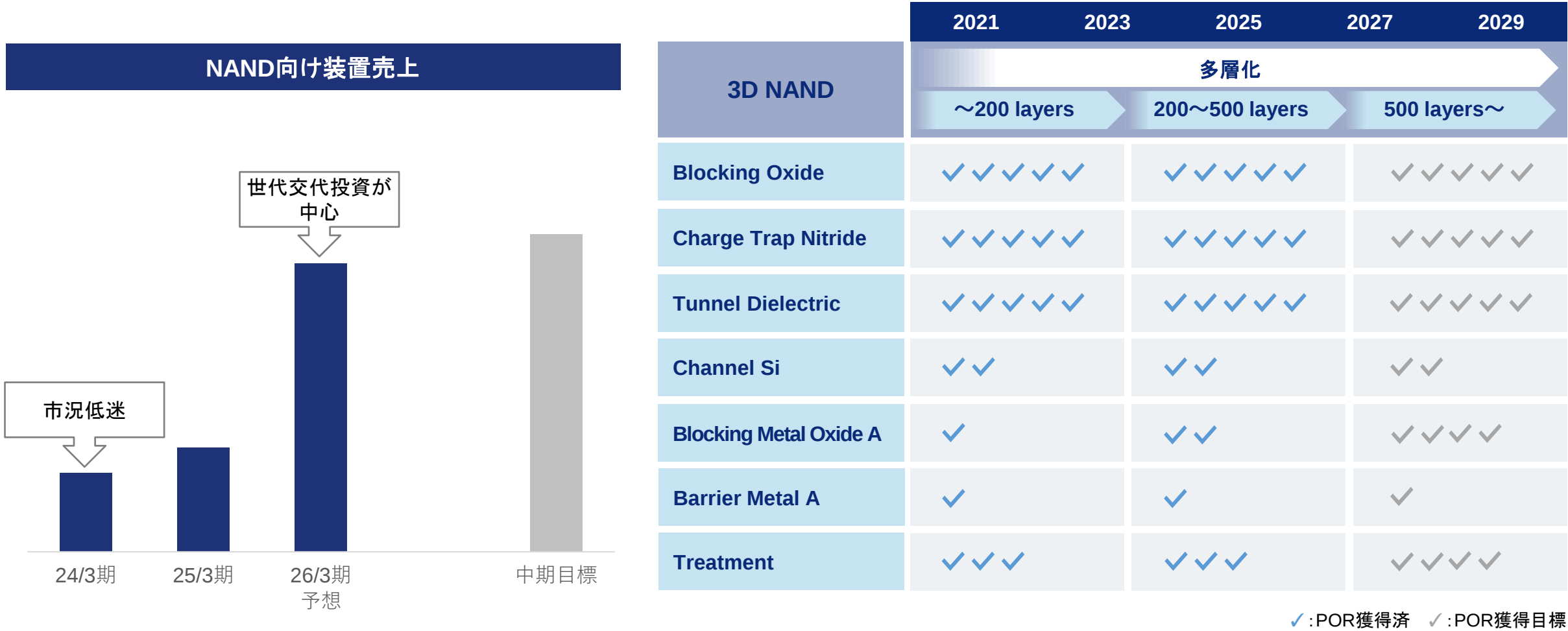
Logic/Foundry、DRAMの先端デバイス向けが世界各国向け装置需要を引き続きけん引。
NANDでは、世界各国向け、中国地場向けとも世代交代に伴う高付加価値装置の需要が増加する見通し。

下線は、第3四半期決算発表時点からの主な変更箇所です。

	事業環境	当社
NAND	- 世界各国向けで<u>デバイス世代交代に向けた装置需要が回復</u>。 - 中国地場向けでも<u>3期ぶりに需要回復</u>。	<u>デバイス世代交代</u>に伴い高付加価値製品の入れ替え・改造が増加。 - 中国地場向けで<u>大型受注獲得</u>、売上増加へ。
DRAM	- 生成AIの普及によるHBM需要拡大により、<u>デバイス世代交代に向けた装置需要</u>が増加。 - 中国大手デバイスメーカーの投資端境期にあたる<u>25年前半は一時的に需要が減少</u>。	<u>先端デバイス世代交代向け装置売上</u>が増加。D1c世代でバッチALD^{*1}対応装置、枚葉トリートメント装置の新規POR獲得、次世代デバイス世代向けでもPOR拡大をめざす。 - デバイスメーカーの<u>生産規模拡大投資</u>は慎重に見積もり。
Logic/Foundry	- 最大手デバイスメーカーの積極投資により、<u>先端ノード向け装置需要</u>が増加。 <u>中国成熟ノード向け装置需要</u>は相応の規模が持続、<u>欧米成熟ノード向け装置需要</u>は一定期間、投資抑制が続く。	<u>GAA第1世代向け</u>は順調に売上が増加し、今後の<u>GAA第2世代、CFETへの移行</u>に伴う売上拡大に期待。 <u>欧米成熟ノード向け</u>はシェア拡大に向けた取り組みを継続し、需要回復に備える。
SiC/GaNパワーデバイス (サービスビジネス)	- 世界各国では需要減少も、<u>中国では需要持続</u>。 - ウェーハサイズが<u>150mmから200mmに移行</u>するのに合わせて需要拡大に期待。	- 既存製品の売上伸長、<u>高温活性化アニール新製品で初POR獲得</u>。 - ALD^{*1}関連の<u>新たなソリューション開発</u>にも注力。

NAND向け装置ビジネスの現状と見通し

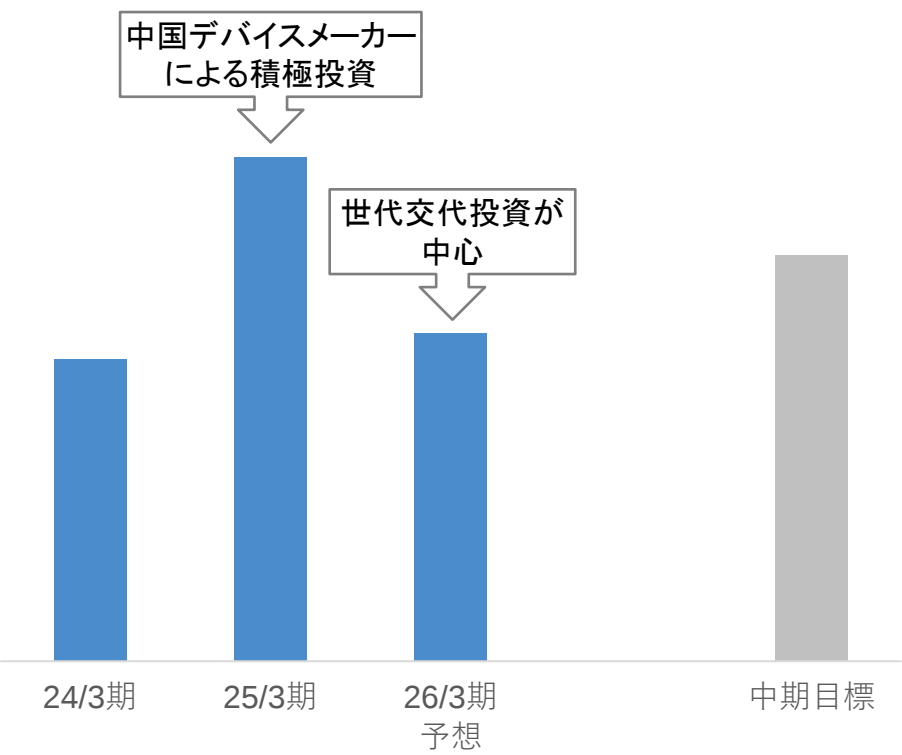
26/3期はデバイスメーカー各社の3D NAND世代交代投資が進むと予想。
当社はPOR維持・拡大により最上位機種の新規需要・アップグレード需要を見込む。



DRAM向け装置ビジネスの現状と見通し

26/3期はデバイスメーカー各社の世代交代投資が進むと予想。生産規模拡大投資には慎重な見方。
当社はPOR維持・拡大により成膜装置の需要増加とトリートメント装置の新規需要を見込む。

DRAM向け装置売上



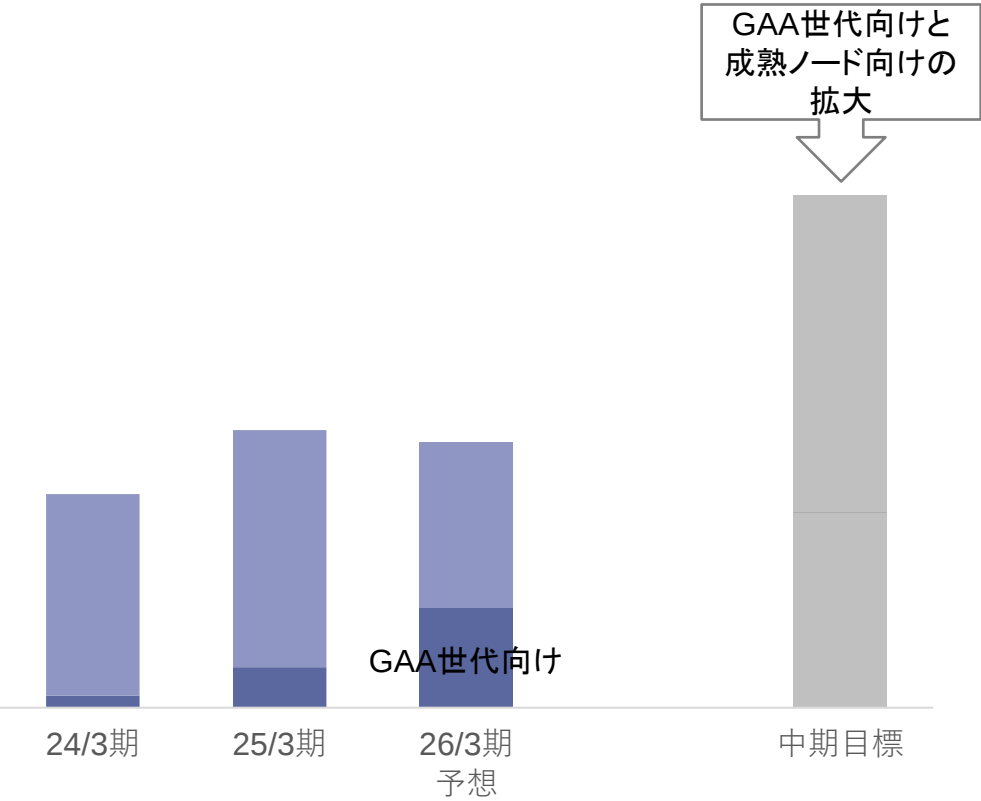
	2021	2023	2025	2027
Advanced 2D DRAM	微細化・複雑化→三次元化			
	D1a	D1b	D1c	D1d
bWL	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
└ Treatment	—	—	—	✓✓✓✓✓
Top Electrode	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓
Bottom Electrode	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓
└ Treatment	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓
Cylinder Support	—	—	—	✓

✓:POR獲得済 ✓:POR獲得目標

Logic/Foundry向け装置ビジネスの現状と見通し

26/3期は最大手デバイスメーカーのGAA第1世代向け投資が進むと予想。
当社はGAA特有の高難易度成膜POR獲得により新規需要を見込む。第2世代向けの取り組みにも注力。

Logic/Foundry向け装置売上



	2023	2024	2025	2026	2027
Logic	複雑化→三次元化				
	FinFET	GAA(2nm)	GAA(1.4nm)		
Gate Spacer	✓✓✓	✓✓✓		✓✓✓✓✓	
Inner Spacer	—	✓✓✓		✓✓✓	
Hard Mask*1	—	✓		✓✓✓✓✓	
Gapfill	—	✓		✓✓✓✓✓	
Treatment	—	—		✓✓✓✓✓	

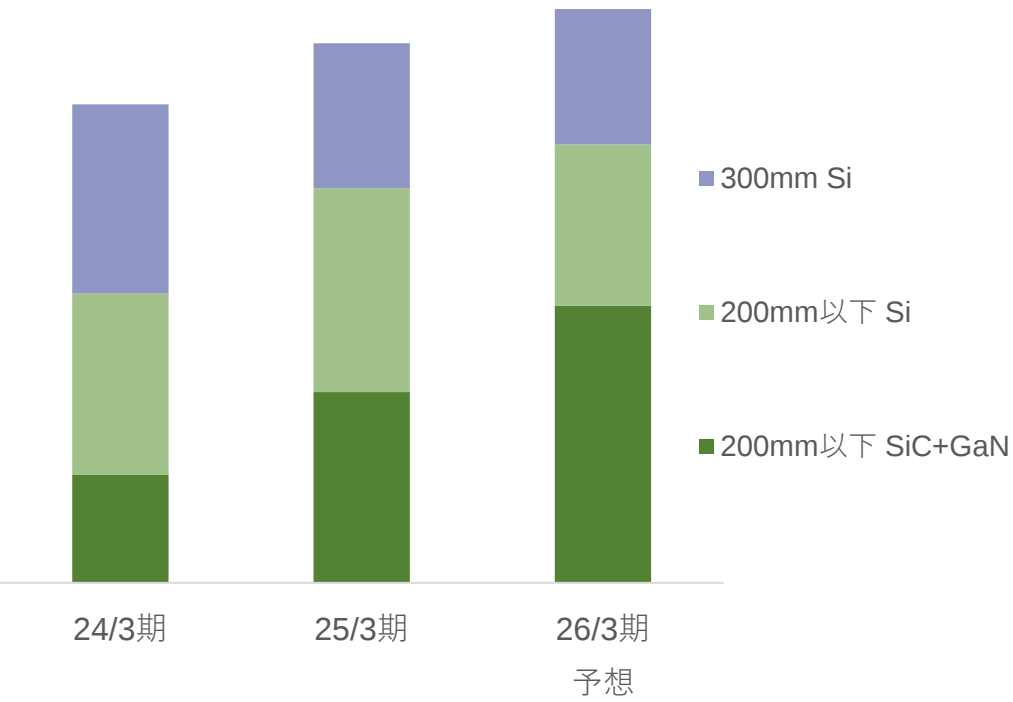
*1 ナノシート保護用のハードマスク

✓ : POR獲得済 ✓ : POR獲得目標

パワーデバイス向けビジネスの現状と見通し

25/3期は高温活性化アニール新製品で初POR獲得、200mm PORが150mm PORを超過。
26/3期は強化した事業基盤を生かし、SiCパワーデバイス向け売上拡大を見込む。

パワーデバイス向け装置売上

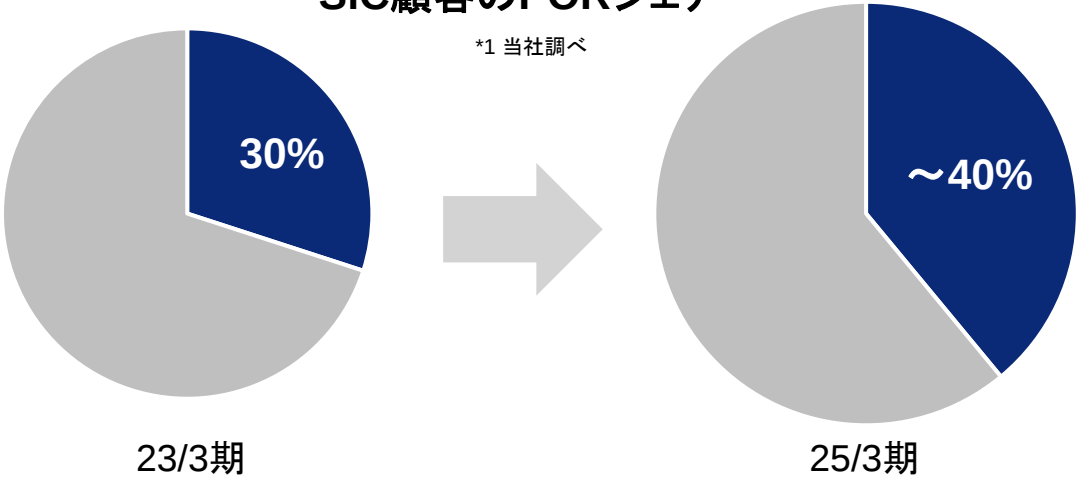


VERTEX® Revolution

- 共通プラットフォームによる操作性の統一
- メンテナンス作業の一貫性
- スペアパーツの共通化による在庫コストの最適化
- Wafer Protection SystemによるSiCウェーハのスクラップコスト低減
- 省エネヒータによる優れた環境性能

SiC顧客のPORシェア*1

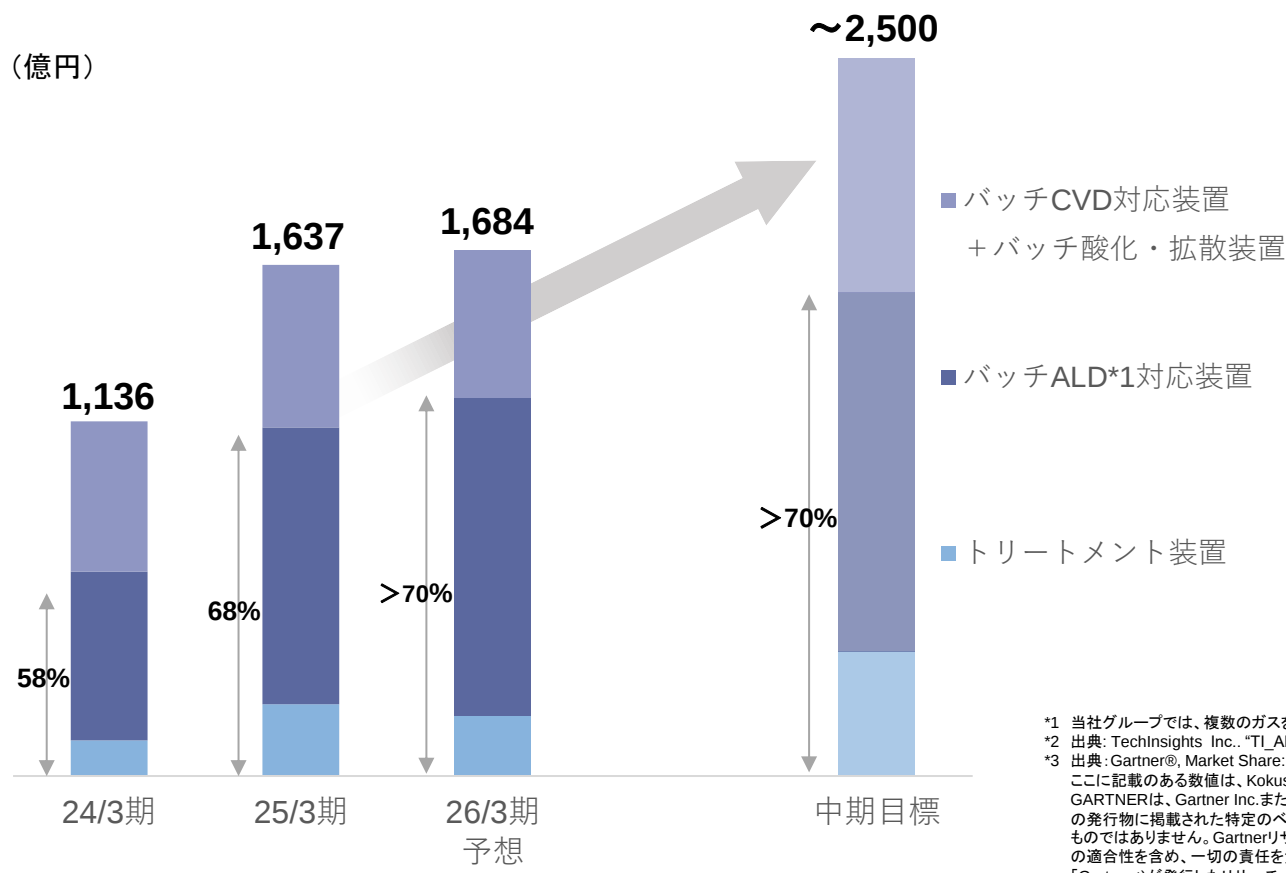
*1 当社調べ



製品構成の現状と見通し

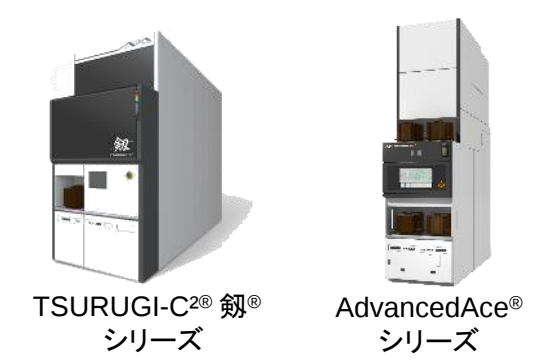
デバイスの世代交代に伴い、バッチALD*¹対応装置、枚葉トリートメント装置の構成比が拡大。
高付加価値製品構成比の上昇が中国地場向け売上比率の低下による影響を吸収し、収益性は上昇。

装置売上(サービス売上含まず)



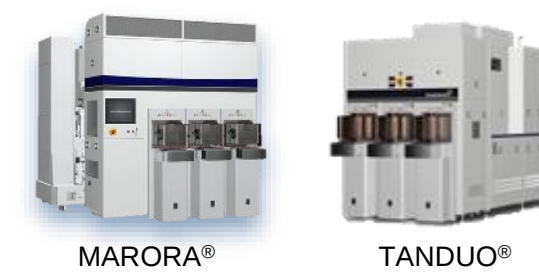
バッチ成膜装置

- バッチALD対応装置
世界シェア No.1 (2024年)*²
- バッチCVD対応装置
- バッチ酸化・拡散装置



トリートメント装置

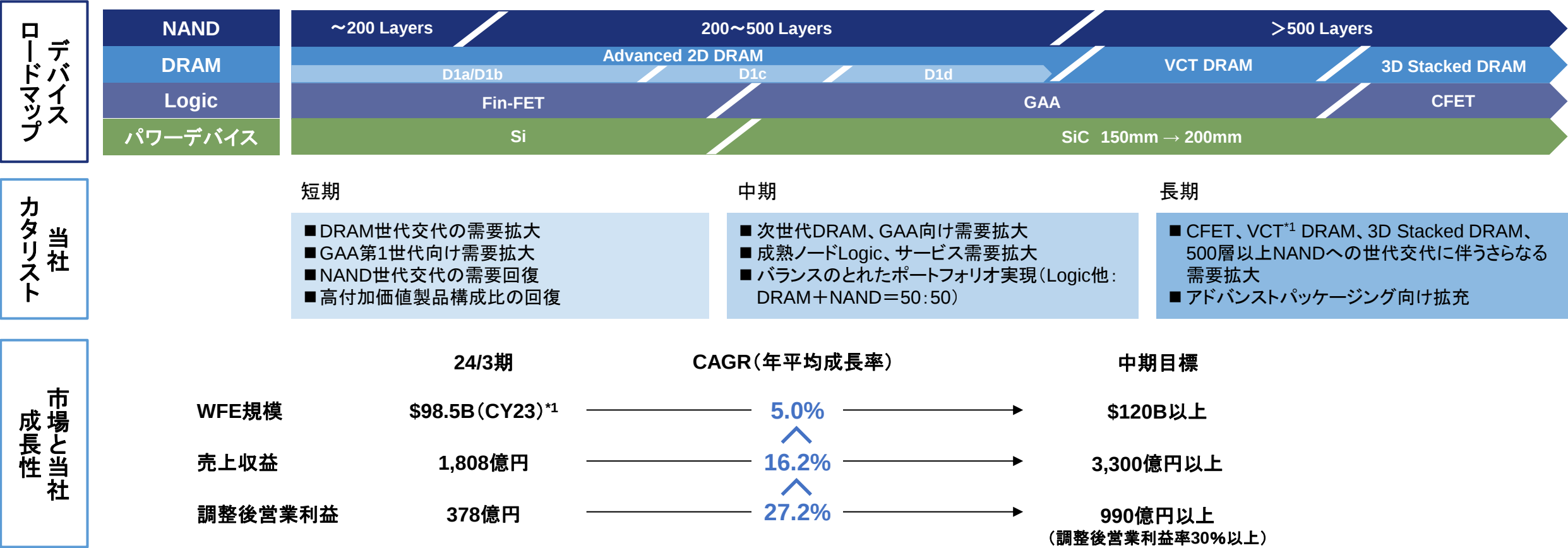
- Plasma Gate Modification Tools
世界シェア No.1 (2024年)*³
- Others



*¹ 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
*² 出典: TechInsights Inc.. "TI_ALD Tools_YEARLY" (April 2025)
*³ 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al, Published 21 April 2025
ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。トリートメント装置: RTP and Oxidation/Diffusion。
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

まとめ

半導体デバイスの進化に伴う微細化・複雑化・三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大をめざす。



*1 出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)



Appendix

損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	24/3期					25/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上収益	32,710	44,995	53,956	49,177	180,838	65,224	49,324	60,117	64,268	238,933
売上総利益	14,275	19,890	21,741	19,059	74,965	29,354	22,012	24,865	25,512	101,743
売上総利益率	43.6%	44.2%	40.3%	38.8%	41.5%	45.0%	44.6%	41.4%	39.7%	42.6%
調整後営業利益	5,614	11,035	12,400	8,790	37,839	19,382	11,299	13,876	13,196	57,753
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	23.0%	17.9%	20.9%	29.7%	22.9%	23.1%	20.5%	24.2%
調整後当期(四半期)利益	3,782	7,304	9,101	7,109	27,296	14,345	7,262	9,646	11,050	42,303
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	16.9%	14.5%	15.1%	22.0%	14.7%	16.0%	17.2%	17.7%
営業利益	3,990	9,383	10,689	6,683	30,745	17,878	9,562	12,274	11,606	51,320
営業利益率	12.2%	20.9%	19.8%	13.6%	17.0%	27.4%	19.4%	20.4%	18.1%	21.5%
税引前当期(四半期)利益	3,727	9,145	10,742	6,143	29,757	17,747	10,195	11,241	11,606	50,789
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	19.9%	12.5%	16.5%	27.2%	20.7%	18.7%	18.1%	21.3%
当期(四半期)利益	2,655	6,158	7,914	5,647	22,374	13,302	4,751	8,004	9,947	36,004
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	14.7%	11.5%	12.4%	20.4%	9.6%	13.3%	15.5%	15.1%
研究開発費	2,932	3,023	3,062	3,666	12,683	3,348	3,920	3,755	4,581	15,604
設備投資額	5,077	2,071	10,478	2,828	20,454	11,215	3,015	2,494	3,624	20,348
減価償却費	2,637	2,671	2,792	2,845	10,945	2,914	3,027	3,328	3,357	12,625

調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	24/3期					25/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業利益	3,990	9,383	10,689	6,683	30,745	17,878	9,562	12,274	11,606	51,320
－その他の収益	△30	△110	△285	△254	△679	△92	△187	△28	△41	△348
＋その他の費用	45	33	19	390	487	27	78	79	69	253
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369	1,479	1,477	1,475	1,476	5,907
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	9	223	12	298	3	4	317
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	370	694	78	71	73	82	304
調整額 計	1,609	1,729	1,977	1,971	7,286	1,569	1,846	1,551	1,562	6,528
調整後営業利益	5,614	11,035	12,400	8,790	37,839	19,382	11,299	13,876	13,196	57,753
当期(四半期)利益	2,655	6,158	7,914	5,647	22,374	13,302	4,751	8,004	9,947	36,004
－その他の収益	△30	△110	△285	△254	△679	△92	△187	△28	△41	△348
＋その他の費用	45	33	19	390	487	27	78	79	69	253
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	1,592	6,369	1,479	1,477	1,475	1,476	5,907
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	9	223	12	298	3	4	317
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	370	694	78	71	73	82	304
－調整項目に対する税金調整額	△497	△506	△524	△645	△2,172	△461	△531	△491	△487	△1,970
＋一時的な税金費用の調整額	-	-	-	-	-	-	1,305	531	-	1,836
調整後当期(四半期)利益	3,782	7,304	9,101	7,109	27,296	14,345	7,262	9,646	11,050	42,303

貸借対照表及び主要財務指標

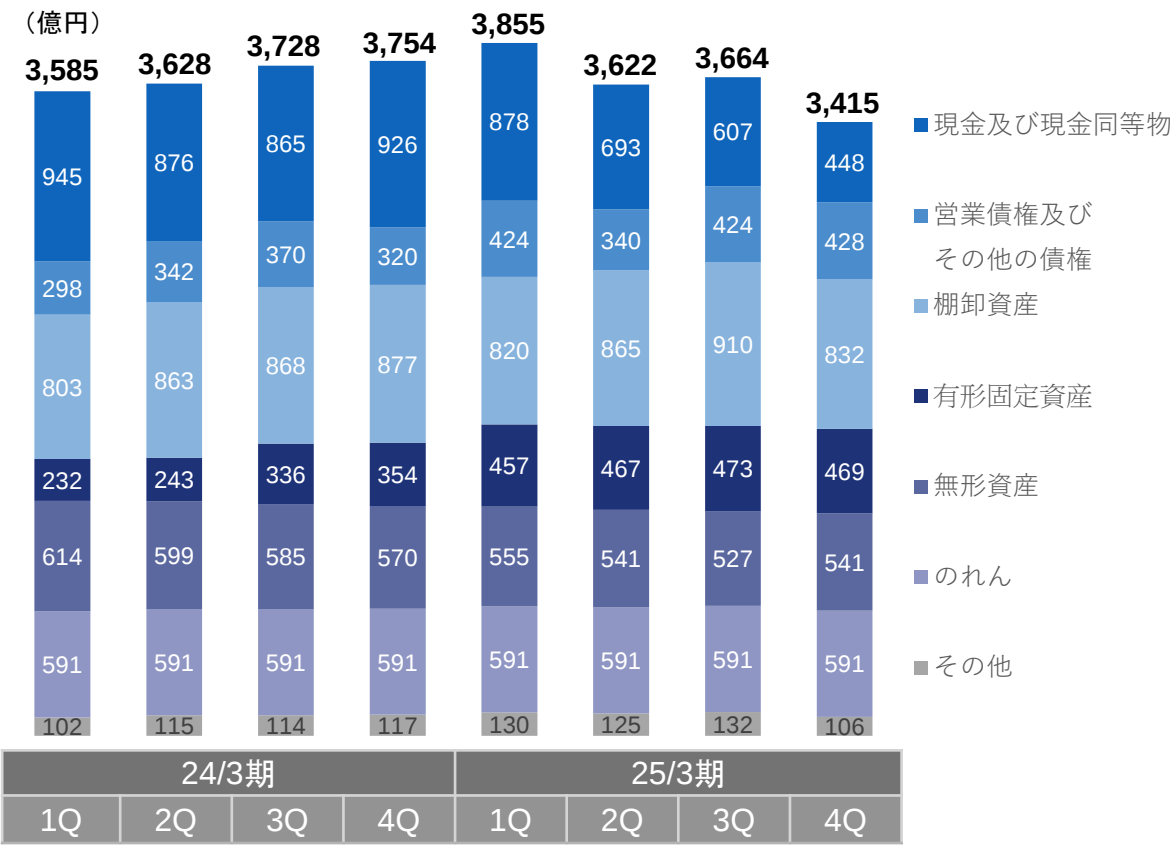
			24/3期	25/3期			
(百万円)			4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末
資産	流動資産	現金及び現金同等物	92,619	87,775	69,333	60,722	44,755
		営業債権及びその他の債権	31,994	42,444	33,979	42,369	42,835
		棚卸資産	87,682	82,028	86,542	91,019	83,200
		その他	2,619	2,787	1,923	1,923	2,062
		流動資産合計	214,914	215,034	191,777	196,033	172,852
	非流動資産	有形固定資産	35,382	45,696	46,714	47,341	46,904
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065
		無形資産	56,995	55,480	54,073	52,652	54,139
		その他	9,077	10,179	10,609	11,309	8,552
		非流動資産合計	160,519	170,420	170,461	170,367	168,660
資産合計			375,433	385,454	362,238	366,400	341,512

			24/3期	25/3期			
(百万円)			4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末
負債	流動負債	借入金＋リース負債	8,019	8,055	8,843	8,843	11,928
		営業債務及びその他の債務	36,667	38,657	31,275	30,328	23,606
		契約負債	22,719	19,394	19,734	19,822	22,455
		その他	20,138	19,554	22,510	23,180	24,682
		流動負債合計	87,543	85,660	82,362	82,173	82,671
	非流動負債	借入金＋リース負債	84,999	85,555	81,059	80,982	48,256
		その他	15,503	15,199	15,900	15,344	14,417
		非流動負債合計	100,502	100,754	96,959	96,326	62,673
負債合計		188,045	186,414	179,321	178,499	145,344	
資本合計		187,388	199,040	182,917	187,901	196,168	
負債及び資本合計		375,433	385,454	362,238	366,400	341,512	

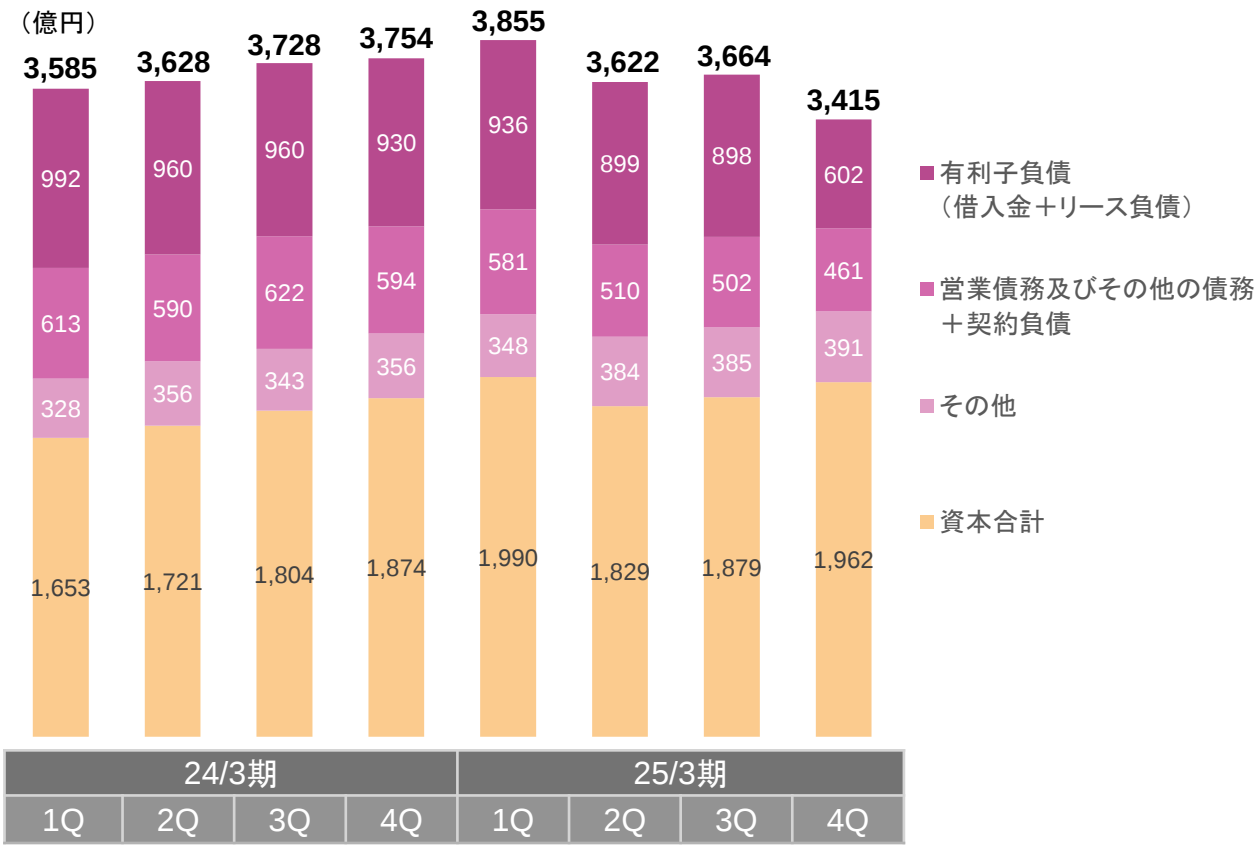
	24/3期	25/3期			
	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末
自己資本比率	49.9%	51.6%	50.5%	51.3%	57.4%
D/Eレシオ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 399	△ 5,835	△ 20,569	△ 29,103	△ 15,429

四半期別貸借対照表

資産

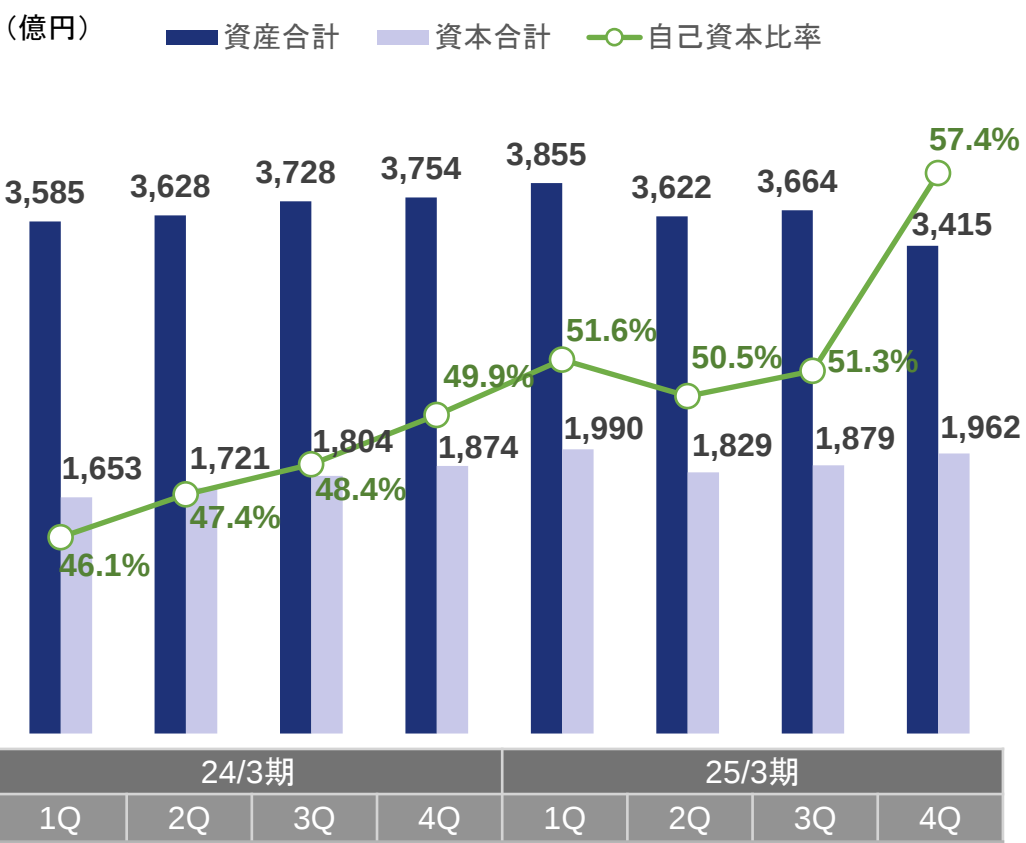


負債／資本

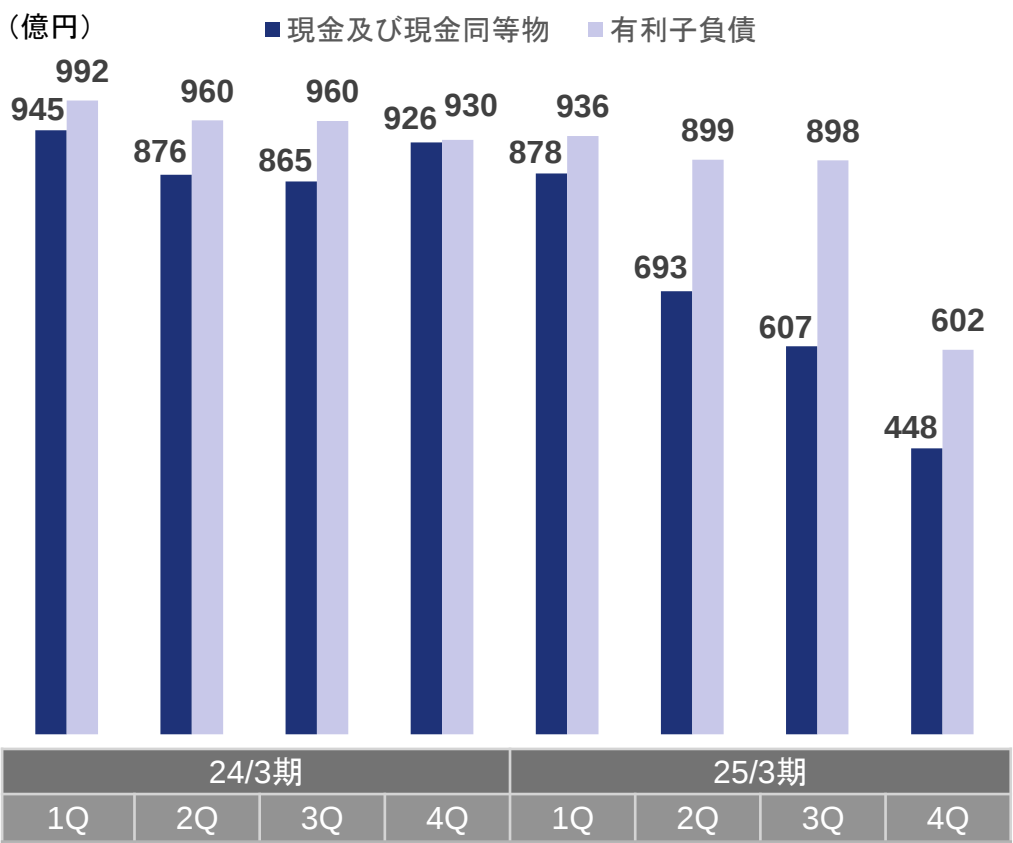


四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

資産合計／資本合計／自己資本比率



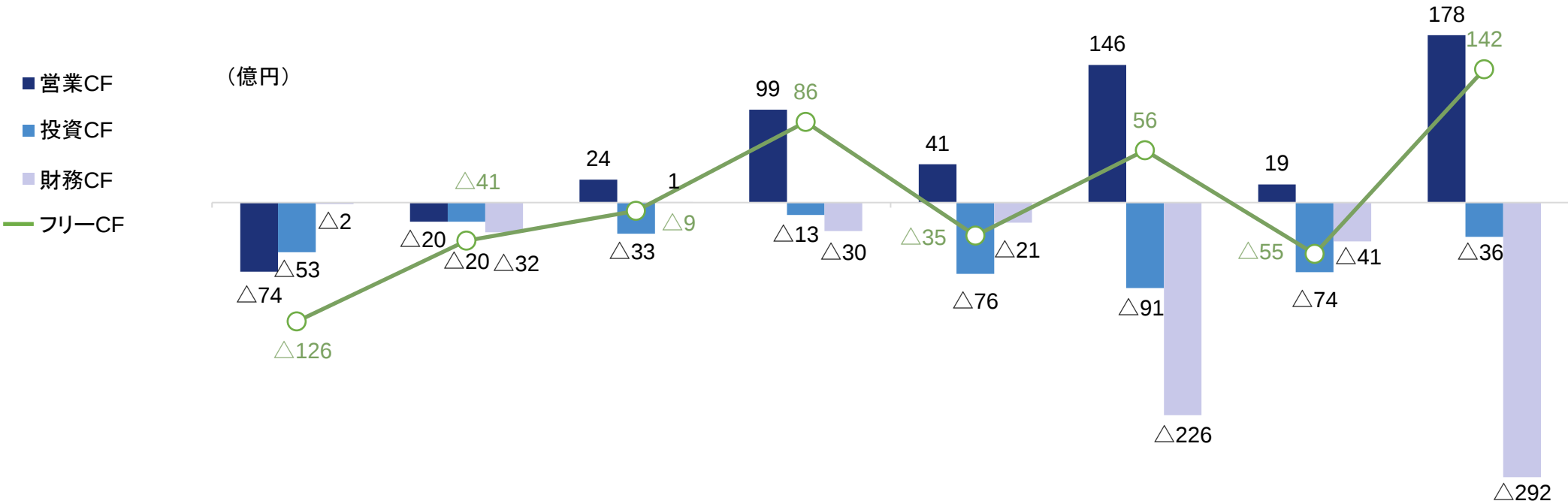
現金及び現金同等物／有利子負債



キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	24/3期					25/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,365	△ 2,030	2,443	9,894	2,942	4,073	14,649	1,936	17,819	38,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,278	△ 2,037	△ 3,321	△ 1,314	△ 11,950	△ 7,582	△ 9,090	△ 7,393	△ 3,641	△ 27,706
フリー・キャッシュ・フロー	△ 12,643	△ 4,067	△ 878	8,580	△ 9,008	△ 3,509	5,559	△ 5,457	14,178	10,771
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167	△ 3,171	70	△ 3,044	△ 6,312	△ 2,143	△ 22,628	△ 4,128	△ 29,207	△ 58,106
現金及び現金同等物の期首残高	106,053	94,493	87,550	86,498	106,053	92,619	87,775	69,333	60,722	92,619
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,493	87,550	86,498	92,619	92,619	87,775	69,333	60,722	44,755	44,755

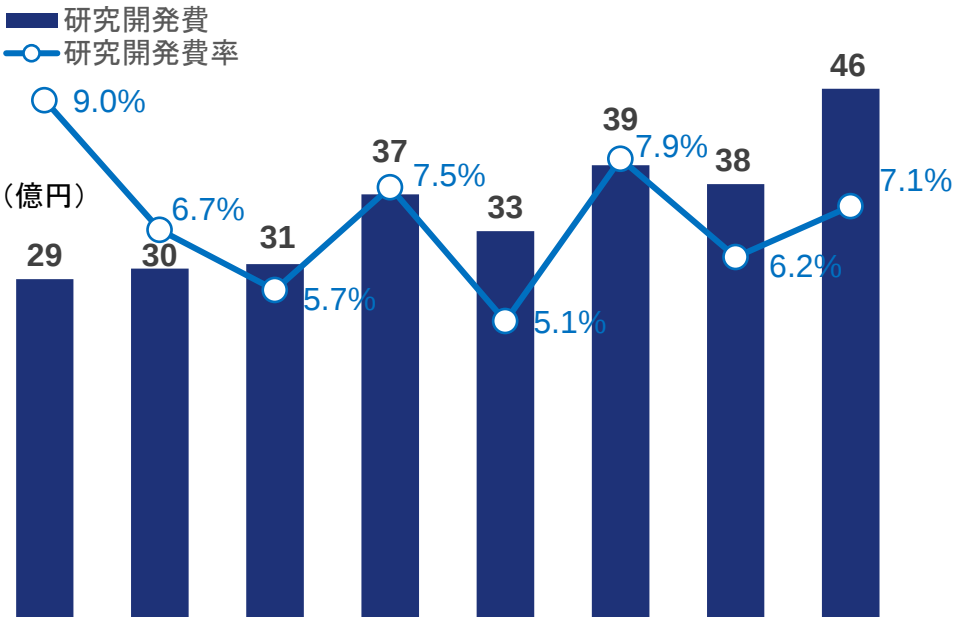
四半期別キャッシュ・フロー



(億円)	24/3期				25/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
営業CF	△74	△20	+24	+99	+41	+146	+19	+178
投資CF	△53	△20	△33	△13	△76	△91	△74	△36
財務CF	△2	△32	+1	△30	△21	△226	△41	△292
フリーCF	△126	△41	△9	+86	△35	+56	△55	+142
現金及び現金同等物残高	945	876	865	926	878	693	607	448

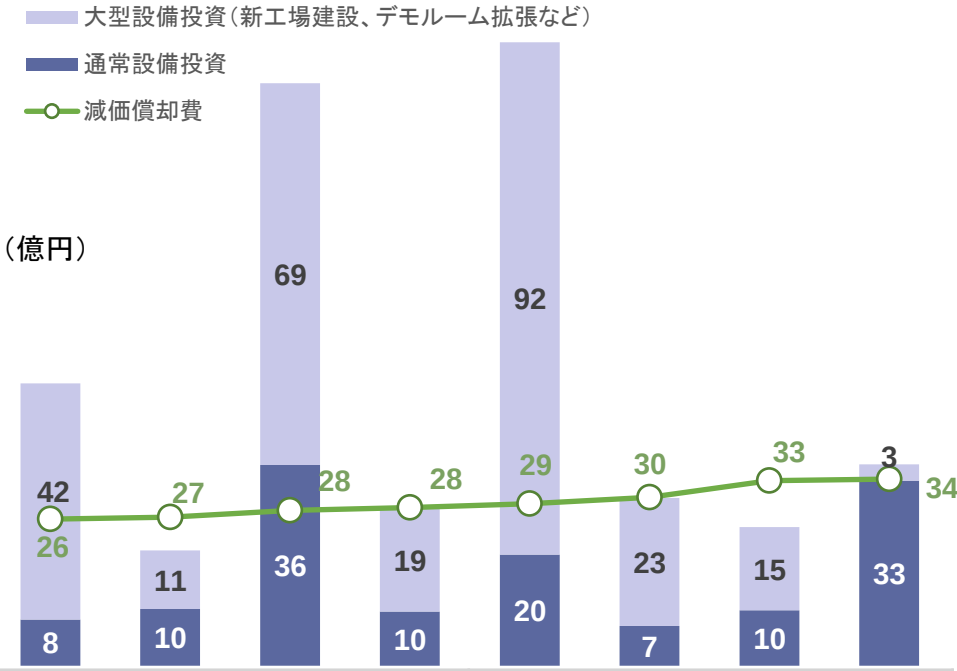
四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

研究開発費



(億円)	24/3期				25/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
研究開発費	29	30	31	37	33	39	38	46
売上収益比	9.0%	6.7%	5.7%	7.5%	5.1%	7.9%	6.2%	7.1%

設備投資額／減価償却費



(億円)	24/3期				25/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
設備投資額計	51	21	105	28	112	30	25	36
売上収益比	15.5%	4.6%	19.4%	5.8%	17.2%	6.1%	4.1%	5.6%
減価償却費	26	27	28	28	29	30	33	34
売上収益比	8.1%	5.9%	5.2%	5.8%	4.5%	6.1%	5.5%	5.2%

2025年3月期第4四半期の主な活動報告

経営・事業活動

- 「SEMICON® CHINA 2025」に出展。(25/3)
- A-STEPの「産学共同 ステージⅡ」に採択。(25/3)
- 第72回 応用物理学会 春季学術講演会に協賛。(25/3)
- EDTM 2025の口頭発表を実施。(25/3)
- 米レクシスネクシス社のInnovation Momentum 2025: The Global Top 100に選出。(25/2)
- 「SEMICON® KOREA 2025」に出展。(25/2)



各地域のSEMICON®に出展

ESGの取り組み

- TABLE FOR TWOから「2025年シルバーパートナー」として認定。(25/3)
- 健康経営優良法人2025(大規模法人部門)に認定。(25/3)
- CDP 2024においてAリスト企業に選定。(25/2)
- 「カターレ富山」とのオフィシャルパートナー契約を継続。(25/2)
- 富山事業所で「とやま水の郷でんき」の使用量を引き上げ。(25/1)



健康経営優良法人2025(大規模法人部門)に認定

2025年3月期第3四半期までの主な活動報告 経営・事業活動

- SEMICON® JAPAN 2024に出展。(24/12)
- KOKUSAI ELECTRIC 社員持株会を設立。(24/11)
- SK hynixの「Best Partner Award」で「優秀協力会社」を受賞。(24/11)
- SEMICON® EUROPA 2024に出展。(24/11)
- 新工場「砺波事業所」が稼働開始。(24/10)
- 当社初となる統合報告書を発行。(24/10)
- 新工場「砺波事業所」の竣工式を開催。(24/9)
- 第85回 応用物理学会 秋季学術講演会、ADMETA Plus 2024に協賛。(24/9)
- SEMICON® TAIWAN 2024に出展。(24/9)
- 2024 SSDMにプラチナスポンサーとして協賛。(24/8)
- 自己株式(5,058,400株)の取得完了。(24/9)
- 当社普通株式(60,381,700株)の売出し完了。(24/7)
- SEMICON® WEST 2024に出展。(24/7)
- 「FTSE Global Equity Index Series」構成銘柄に当社が採用。(24/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」と「THE BEST Suppliers」を受賞。(24/5)
- PSMCの新工場開所式で感謝状を受領。(24/5)



砺波事業所が2024年10月に稼働

2025年3月期第3四半期までの主な活動報告 ESGの取り組み

- 「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」の構成銘柄に選定。(24/11)
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書を更新。(24/11)
- 地域貢献活動の一環として近隣保育所から親子社会見学を受入。(24/10)
- 砺波事業所で「とやま水の郷でんき」を導入。(24/10)
- 「とやま女性活躍企業」に認定。(24/9)
- 富山市八尾町で開催された「おわら風の盆」に協賛。(24/9)
- 献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰を受賞。(24/7)
- 富山事業所がRBAのVAP監査で最高評価のプラチナ・ステータスを取得。(24/5)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(24/5)
- 「WOMEN IN SEMICONDUCTORS」でゲストプレゼンテーションを実施。(24/5)
- 富山県砺波市で開催された「2024となみチューリップフェア」に協賛。(24/4)



©(公社)とやま観光推進機構



富山市八尾町で開催されたおわら風の盆に協賛



MSCI ESG格付けにおいて「AA」評価を獲得

^{*1} THE USE BY KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES ("MSCI") DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS AND ARE PROVIDED 'AS-IS' AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

用語集

- バッチ成膜装置：多数のウェーハを一括処理するバッチ方式により成膜を行う装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE: Wafer Fab Equipmentの略

